# WH<sup>®</sup>

# CH32L103 数据手册

V1.7

### 概述

CH32L103 是基于青稞 RISC-V 内核设计的工业级低功耗通用微控制器。CH32L103 内置 USB 和 PD PHY, 支持 PDUSB,包括 USB Host 主机和 USB Device 设备功能、USB PD 及 Type-C 快充功能,内置低功耗定时器,提供了 1 组 OPA 运放、3 组 CMP 电压比较器、4 组 USART 串口、2 个 I2C 接口、2 个 SPI接口、1 组 CAN 接口、多组定时器、12 位 ADC、10 路 Touchkey 等丰富外设资源。

# 产品特性

#### ● 内核 Core:

- 青稞 32 位 RISC-V4C 内核
- 支持 RV321MAC 指令集和自扩展指令
- 快速可编程中断控制器+硬件中断堆栈
- 分支预测、冲突处理机制
- 单周期乘法、硬件除法
- 系统主频 96MHz

#### ● 存储器:

- 20KB 易失数据存储区 SRAM
- 64KB 程序存储区 CodeFlash
- 3328B 系统引导程序存储区 BootLoader
- 256B 系统非易失配置信息存储区
- 256B 用户自定义信息存储区

#### ● 电源管理和低功耗:

- 系统供电 V<sub>D</sub> 额定: 3.3V
- 低功耗模式: 睡眠、停止、待机
- VBAT 电源独立为 RTC 和后备寄存器供电

#### ● 系统时钟和复位:

- 内置出厂调校的 8MHz 的 RC 振荡器
- 内置约 40KHz 的 RC 振荡器
- 内置 PLL, 可选 CPU 时钟达 96MHz
- 外部支持 3~25MHz 高速振荡器
- 外部支持 32. 768KHz 低速振荡器
- 上/下电复位、可编程电压监测器
- 实时时钟 RTC: 32 位独立定时器
- 8路通用 DMA 控制器:
- 8 个通道. 支持环形缓冲区管理
- 支持 TIMx/ADC/USART/I2C/SPI
- 3组模拟电压比较器 CMP:
- 各 2 路输入通道, 可选公用参考电压引脚
- 输出到 I/0 或者内部直接触发 TIM2

#### ● 1 组运放 OPA/PGA/电压比较器:

- 多路输入通道, 可选多档增益
- 多路输出通道, 可选 ADC 引脚
- 12 位模数转换 ADC:
- 模拟输入范围: V<sub>SSA</sub>~V<sub>DDA</sub>
- 10 路外部信号通道+3 路内部信号通道
- 片上温度传感器
- 10 路 TouchKey 通道检测
- 16 位低功耗定时器
- 多组定时器:
- 1 个 16 位高级定时器,提供死区控制和紧急 刹车,提供用于电机控制的 PWM 互补输出
- -2个16位通用定时器,提供输入捕获/输出比较/PWM/脉冲计数及增量编码器输入
- 1 个 32 位通用定时器
- 2 个看门狗定时器: 独立和窗口型
- 系统时基定时器: 64 位计数器
- 4组 USART 串口: 支持 LIN 和 IS07816
- 2个 I2C接口:支持 SMBus/PMBus
- 2个 SPI 接口
- 1组 CAN 接口(2.0B 主动):
- 支持 CAN FD 协议
- USB 2.0 全速控制器及 PHY:
- 支持 USB 主机或 USB 设备
- USB PD 和 Type-C 控制器及 PHY:
- 支持 DRP、Sink 和 Source 应用
- 支持 PDUSB
- 快速 GPI0 端口:
- 37 个 I/0 口,支持 16 个外部中断
- 安全特性:芯片唯一 ID
- 调试模式:串行2线调试接口 SDI
- 封装形式: LQFP、QFN、QSOP、TSSOP

<b>一</b> 资》	原	型号	C8T6	K8U6	G8R6	F8U6	F8P6					
	芯片引展	脚数	48	32	28	20	20					
	闪存(字	2节)	64K	64K	64K	64K	64K					
	SRAM(字	2节)	20K	20K	20K	20K	20K					
	GP10 端	口数	37	31	26	19	16					
	高级 TIM1	(16位)	1	1	1	1	1					
	通用 TIM2、	TIM3(16位)	2	2	2	2	2					
定时	通用 TIM4	(32位)	1	1	1	1	1					
器	低功耗定时	器(LPTIM)	<b>√</b>	<b>√</b>	√	√	√					
i fif	看i	]狗		2 ( WWDG + IWDG )								
	系统时基	(64位)			<b>√</b>							
	RTC				<b>√</b>							
	ADC		10+3	10+3	10+3	10+3 9+3						
	Tkey	<i>'</i>	10 路	10 路	10 路	10 路	9路					
	OPA		1	1	1	1	1					
	CMP		3	3	3	3	CMP1 CMP2					
	USA	ART	4	4	4	4	4					
	SI	PI	2	SPI1	2	2	SPI1					
	13	2C	2	1201	2	2	1201					
通	C	AN	1	1	1	1	1					
信		USB Host	Host	Host	Host	Host	Device					
接		Device	Device	Device	Device	Device	Device					
	PDUSB	USB PD Type-C	DRP Source Sink	DRP Source Sink 内置 Rd <sup>⑴</sup>	DRP Source Sink	DRP Source Sink 内置 Rd <sup>⑴</sup>	DRP Source Sink					
	CPU 主	频			Max: 96MHz							
	额定电	.压			3. 3V							
	工作温	l度		5°C								
	封装形	<b></b>	LQFP48	QFN32	QSOP28	QFN20	TSS0P20					
	主要应用。	及特点	通用, 引脚兼容	通用, 引脚优化	通用, 电机主控	电机主控 引脚优化	通用,引脚兼容					

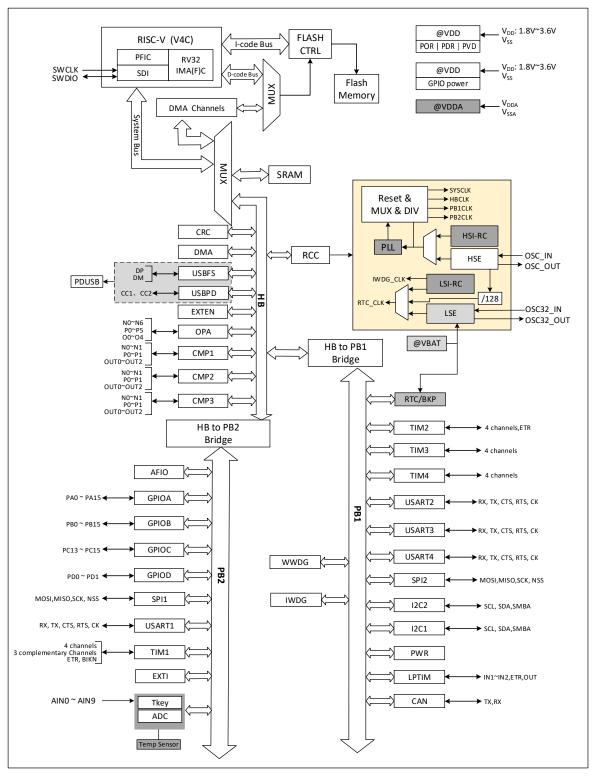
注: 1. CH32L103K8U6 和 F8U6 内置 Type-C 规范定义的可控 Rd 下拉电阻,约 5. 1k Ω。

# 第1章 规格信息

# 1.1 系统架构

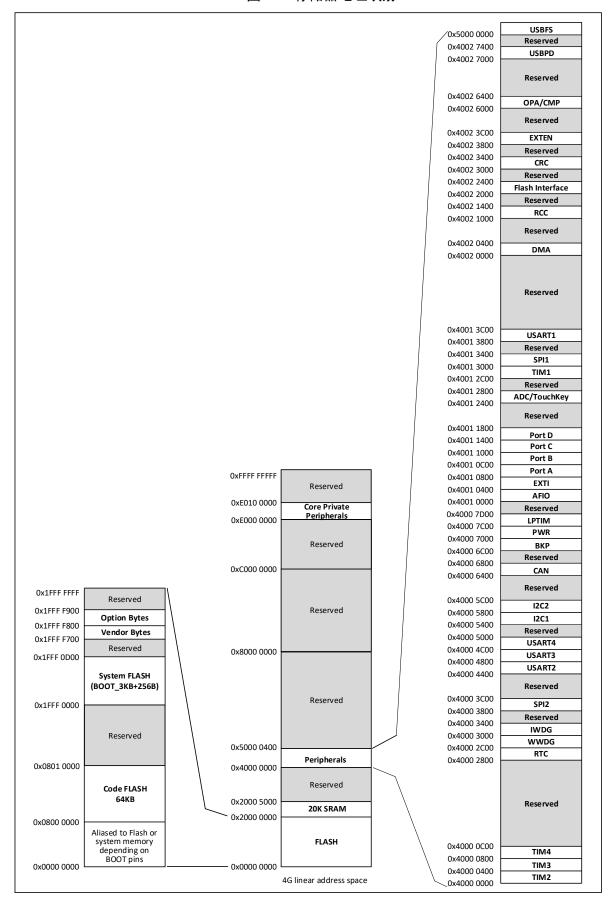
微控制器基于 RISC-V 指令集设计,其架构中将青稞微处理器内核、仲裁单元、DMA 模块、SRAM 存储等部件通过多组总线实现交互。集成通用 DMA 控制器以减轻 CPU 负担、提高访问效率,应用多级时钟管理机制降低了外设的运行功耗,同时兼有数据保护机制,时钟自动切换保护等措施增加了系统稳定性。下图是系列芯片内部总体架构框图。

图 1-1 系统框图



# 1.2 存储器映射表

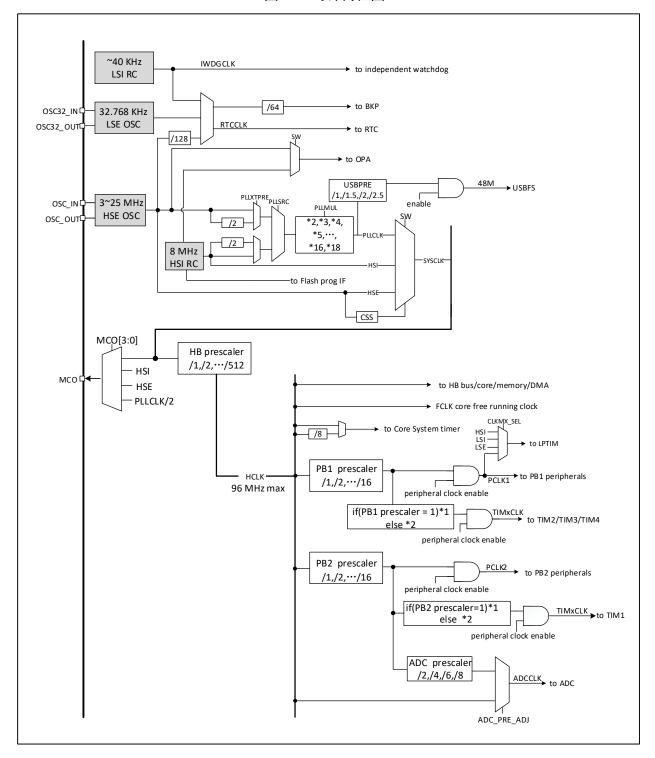
图 1-2 存储器地址映射



#### 1.3 时钟树

系统中引入 4 组时钟源:内部高频 RC 振荡器 (HSI)、内部低频 RC 振荡器 (LSI)、外接高频振荡器 (HSE)、外接低频振荡器 (LSE)。其中,低频时钟源为 RTC 和独立看门狗提供了时钟基准。高频时钟源直接或者间接通过 PLL 倍频后输出为系统总线时钟 (SYSCLK),系统时钟再由各预分频器提供了 HB 域、PB1 域、PB2 域外设控制时钟及采样或接口输出时钟,部分模块工作需要由 PLL 时钟直接提供。

图 1-3 时钟树框图



#### 1.4 功能概述

#### 1.4.1 RISC-V4C 处理器

RISC-V4C 支持 RISC-V 指令集 IMAC 子集。处理器内部以模块化管理,包含快速可编程中断控制器 (PFIC)、内存保护、分支预测模式、扩展指令支持等单元。对外多组总线与外部单元模块相连,实现外部功能模块和内核的交互。

处理器以其极简指令集、多种工作模式、模块化定制扩展等特点可以灵活应用不同场景微控制器 设计,例如小面积低功耗嵌入式场景、高性能应用操作系统场景等。

- 支持机器和用户特权模式
- 快速可编程中断控制器 (PFIC)
- 多级硬件中断堆栈
- 串行2线调试接口
- 标准内存保护设计
- 静态或动态分支预测、高效跳转、冲突检测机制
- 自定义扩展指令

#### 1.4.2 片上存储器

内置 20K 字节 SRAM 区,用于存放数据、掉电后数据丢失。具体容量要对应芯片型号。

内置 64K 字节程序闪存存储区(Code FLASH),即用户区,用于用户的应用程序和常量数据存储。 区域具体大小对应芯片型号。

内置 3328 字节系统存储区(System FLASH), 即 B00T 区, 用于系统引导程序存储, 内置自举加载程序。

内置 256 字节系统非易失配置信息存储区,用于厂商配置字存储,出厂前固化,用户不可修改。 内置 256 字节用户自定义信息存储区,用于用户选择字存储。

在启动时,通过自举引脚(B00T0和B00T1)可以选择三种自举模式中的一种:

- 从程序闪存存储器自举
- 从系统存储器自举
- 从内部 SRAM 自举

自举加载程序存放于系统存储区,可以通过USART2和USB接口对程序闪存存储区的内容重新编程。

# 1.4.3 供电方案

- V<sub>DD</sub> = 1.8~3.6V: 为部分 I/O 引脚和内部调压器供电。
- V<sub>DDA</sub> = 2.0~3.6V: 为高频 RC 振荡器、ADC、温度传感器及 PLL 的模拟部分供电。正常工作时, V<sub>DDA</sub> 电压不能高于 V<sub>DD</sub> 电压; 使用 ADC 时, V<sub>DDA</sub> 不得小于 2.4V。
- $V_{BAT}$  = 1.8~3.6V:可选的备用电源,当关闭  $V_{DD}$  时,(通过内部电源切换器)单独为 RTC、外部低频振荡器和后备寄存器供电。

# 1.4.4 供电监控器

芯片内部集成了上电复位(POR)/掉电复位(PDR)电路,该电路始终处于工作状态,保证系统在供电超过 1.8V 时工作;当 V<sub>DD</sub>低于设定的阈值(V<sub>POR/PDR</sub>)时,置器件于复位状态,而不必使用外部复位电路。

另外系统设有一个可编程的电压监测器(PVD),需要通过软件开启,用于比较  $V_{10}$  供电与设定的阈值  $V_{PVD}$  的电压大小。打开 PVD 相应边沿中断,可在  $V_{10}$  下降到 PVD 阈值或上升到 PVD 阈值时,收到中断通知。关于  $V_{POR/PDR}$  和  $V_{PVD}$  的值参考第 3 章。

## 1.4.5 系统电压调节器 LDO

复位后, 调节器自动开启, 根据应用方式有三个操作模式

- 开启模式:正常的运行操作,提供稳定的内核电源:
- 低功耗模式: 当 CPU 进入停止模式后, 可选择调节器低功耗运行;
- 关断模式: 当 CPU 进入待机模式后自动切换调节器到此模式,调压器输出为高阻状态,内核电路的供电切断,调压器处于零消耗状态。

该调压器在复位后始终处于开启模式,在待机模式下被关闭处于关断模式,此时是高阻输出。

#### 1.4.6 低功耗模式

系统支持三种低功耗模式,可以针对低功耗、短启动时间和多种唤醒事件等条件下选择达到最佳 的平衡。

#### ● 睡眠模式 (SLEEP)

在睡眠模式下,只有 CPU 时钟停止,但所有外设时钟供电正常,外设处于工作状态。此模式是最 浅低功耗模式,但可以达到最快唤醒。

退出条件:任意中断或唤醒事件。

● 停止模式(STOP)

此模式 FLASH 进入低功耗模式或者断电状态, PLL、HSI 的 RC 振荡器和 HSE 晶体振荡器被关闭。 在保持 SRAM 和寄存器内容不丢失的情况下,停止模式可以达到最低的电能消耗。

停止模式分为四种情况:停止模式 1、停止模式 2、停止模式 3 和停止模式 4,详细信息请参考 CH32L103RM 手册的低功耗模式相关章节。

退出条件:任意外部中断/事件(EXTI信号)、NRST上的外部复位信号、IWDG复位,其中EXTI信号包括37个外部I/0口之一、PVD的输出,RTC闹钟,USB的唤醒信号,USBPD唤醒信号,CMP唤醒信号,LPTIM唤醒信号等。

#### ● 待机模式 (STANDBY)

此模式下,系统主 LDO 关闭,由低功耗 LDO 给唤醒电路供电,其他数字电路全部断电,且 FLASH 处于断电状态。从待机模式唤醒系统会产生复位,同时 SBF (PWR\_CSR)会置位。唤醒后,查询 SBF 状态可知唤醒前的低功耗模式,SBF 由 CSBF (PWR\_CR)位清除。在待机模式下,20KB 的 SRAM 的内容可以保持(取决于睡前的规划配置),后备寄存器内容保留。

退出条件: EXTIO~EXTI17 任一外部事件(不包括中断)、NRST 上的外部复位信号、IWDG 复位, 其中 EXTI 信号包括 37 个外部 I/O 口之一、PVD 的输出,RTC 闹钟等。

#### 1.4.7 CRC(循环冗余校验)计算单元

CRC (循环冗余校验) 计算单元使用一个固定的多项式发生器,从一个 32 位的数据字产生一个 CRC 码。在众多的应用中,基于 CRC 的技术被用于验证数据传输或存储的一致性。在 EN/IEC 60335-1 标准的范围内,提供了一种检测闪存存储器错误的手段, CRC 计算单元可以用于实时地计算软件的签名,并与在链接和生成该软件时产生的签名对比。

# 1.4.8 快速可编程中断控制器 (PFIC)

芯片内置快速可编程中断控制器 (PFIC),最多支持 255 个中断向量,以最小的中断延迟提供了灵活的中断管理功能。当前芯片管理了 4 个内核私有中断和 52 个外设中断管理,其他中断源保留。PFIC的寄存器均可以在用户和机器特权模式下访问。

- 2个可单独屏蔽中断
- 提供一个不可屏蔽中断 NM I
- 支持硬件中断堆栈(HPE), 无需指令开销
- 提供 4 路免表中断 (VTF), 更快进入中断服务程序
- 向量表支持地址或指令模式
- 中断嵌套深度可配置最高2级

#### ● 支持中断尾部链接功能

#### 1.4.9 外部中断/事件控制器(EXTI)

外部中断/事件控制器总共包含 22 个边沿检测器,用于产生中断/事件请求。每个中断线都可以独立地配置其触发事件(上升沿或下降沿或双边沿),并能够单独地被屏蔽;挂起寄存器维持所有中断请求状态。多达 37 个通用 I/0 口都可选择连接到 16 个外部中断线。

#### 1.4.10 通用 DMA 控制器

系统内置了通用 DMA 控制器,管理 8 个通道,灵活处理存储器到存储器、外设到存储器和存储器 到外设间的高速数据传输,支持环形缓冲区方式。每个通道都有专门的硬件 DMA 请求逻辑,支持一个 或多个外设对存储器的访问请求,可配置访问优先权、传输长度、传输的源地址和目标地址等。

DMA 用于主要的外设包括:通用/高级定时器 TIMx、ADC、USART、12C、SPI。

USB 和 USB PD 另有专用的独立 DMA 通道。

注: DMA 和 CPU 经过仲裁器仲裁之后对系统 SRAM 进行访问。

#### 1.4.11 时钟和启动

系统时钟源 HSI 默认开启,在没有配置时钟或者复位后,内部 8MHz 的 RC 振荡器作为默认的 CPU 时钟,随后可以另外选择外部 3~25MHz 时钟或 PLL 时钟。当打开时钟安全模式后,如果 HSE 用作系统时钟(直接或间接),此时检测到外部时钟失效,系统时钟将自动切换到内部 RC 振荡器,同时 HSE 和 PLL 自动关闭;对于关闭时钟的低功耗模式,唤醒后系统也将自动地切换到内部的 RC 振荡器。如果使能了时钟中断,软件可以接收到相应的中断。

多个预分频器用于配置 HB 的频率、高速 PB (PB2) 和低速 PB (PB1) 区域提供各外设时钟,最高频率 96MHz,参考图 1-3 的时钟树框图。

#### 1.4.12 RTC (实时时钟) 和后备寄存器

RTC 和后备寄存器在系统内部处于后备供电区域,在 V<sub>10</sub> 有效时由 V<sub>10</sub> 供电,在 V<sub>10</sub> 无效时内部自动 切换到由 V<sub>84</sub> 引脚供电。

RTC 实时时钟是一组 32 位可编程计数器,时基支持 20 位预分频,用于较长时间段的测量。时钟基准来源高速的外部时钟 128 分频(HSE/128)、外部晶体低频振荡器(LSE)或内部低功耗 RC 振荡器(LSI)。其中 LSE 也存在后备供电区域,所以,当选择 LSE 做 RTC 时基下,系统复位或从待机模式唤醒后,RTC 的设置和时间能够保持不变。

后备寄存器包含 10 个 16 位寄存器,可以用来存储 20 字节的用户应用数据。此数据在待机唤醒后,或系统复位或电源复位时,都能继续保持。在侵入检测功能开启下,一旦侵入检测信号有效,将被清除后备寄存器中所有内容。

# 1.4.13 ADC (模拟/数字转换器) 和触摸按键电容检测 (TKey)

芯片内置 12 位的模拟/数字转换器 (ADC),提供多达 10 个外部通道和 3 个内部通道采样,可编程的通道采样时间,可以实现单次、连续、扫描或间断转换。提供模拟看门狗功能允许非常精准地监控一路或多路选中的通道,用于监测通道信号电压,提供可配置的模拟看门狗复位功能,可在监测到电压超出阈值时复位系统。支持外部事件触发转换,触发源包括片上定时器的内部信号和外部引脚。支持使用 DMA 操作。

ADC 内部通道为 ADC\_IN16~ADC\_IN18。温度传感器在内部被连接到 IN16 输入通道上, 用于将传感器的输出转换到数字数值; 内部参考电压被连接到 IN17 输入通道上; Vook/2 被连接到 IN18 输入通道上。

触摸按键电容检测单元,提供了多达 10 个检测通道,复用 ADC 模块的外部通道。检测结果通过

ADC 模块转换输出结果,通过用户软件识别触摸按键状态。

#### 1.4.14 定时器及看门狗

#### ● 高级控制定时器(TIM1)

高级控制定时器是一个 16 位的自动装载递加/递减计数器, 具有 16 位可编程的预分频器。除了完整的通用定时器功能外, 可以被看成是分配到 6 个通道的三相 PWM 发生器, 具有带死区插入的互补 PWM 输出功能, 允许在指定数目的计数器周期之后更新定时器进行重复计数周期, 刹车功能等。高级控制定时器的很多功能都与通用定时器相同, 内部结构也相同, 因此高级控制定时器可以通过定时器链接功能与其他 TIM 定时器协同操作, 提供同步或事件链接功能。

#### ● 通用定时器(TIM2、TIM3、TIM4)

通用定时器是 2 个 16 位(TIM2、TIM3)和 1 个 32 位(TIM4)的自动装载递加/递减计数器,具有一个可编程的 16 位预分频器以及 4 个独立的通道,每个通道都支持输入捕获、输出比较、PWM 生成和单脉冲模式输出。还能通过定时器链接功能与高级控制定时器共同工作,提供同步或事件链接功能。在调试模式下,计数器可以被冻结,同时 PWM 输出被禁止,从而切断由这些输出所控制的开关。任意通用定时器都能用于产生 PWM 输出。每个定时器都有独立的 DMA 请求机制。这些定时器还能够处理增量编码器的信号,也能处理 1 至 3 个霍尔传感器的数字输出。

#### ● 独立看门狗

独立看门狗是一个自由运行的 12 位递减计数器,支持 7 种分频系数。由一个内部独立的约 40KHz 的 RC 振荡器(LSI)提供时钟。IWDG 在主程序之外,可以完全独立工作,因此,用于在发生问题时复位整个系统,或作为一个自由定时器为应用程序提供超时管理。通过选项字节可以配置成是软件或硬件启动看门狗。在调试模式下,计数器可以被冻结。

#### ● 窗口看门狗

窗口看门狗是一个7位的递减计数器,并可以设置成自由运行。可以被用于在发生问题时复位整个系统。其由主时钟驱动,具有早期预警中断功能;在调试模式下,计数器可以被冻结。

#### ● 系统时基定时器

青稞微处理器内核自带了一个 64 位可选递增或递减的计数器,用于产生 SYSTICK 异常(异常号: 12),可专用于实时操作系统,为系统提供"心跳"节律,也可当成一个标准的 64 位计数器。具有自动重加载功能及可编程的时钟源。

#### 1.4.15 低功耗定时器(LPTIM)

低功耗定时器是一个 16 位的自动装载递加计数器, 具有 3 位可编程的预分频器。可选择软件或者硬件输入触发, 支持 PWM 输出。低功耗定时器可将系统从低功耗模式唤醒,以极低的功耗实现"超时功能"。

#### 1.4.16 通用同步/异步收发器(USART)

芯片提供了 4 组通用同步/异步收发器。支持全双工异步串口通信、同步单向通信以及半双工单线通信,也支持 LIN(局部互连网),兼容 ISO7816 的智能卡协议和 IrDA SIR ENDEC 传输编解码规范,以及调制解调器 (CTS/RTS 硬件流控)操作,还支持多处理器通信。其采用分数波特率发生器系统,并支持 DMA 操作连续通讯。

#### 1.4.17 串行外设接口(SPI)

芯片提供 2 个串行外设 SPI 接口,支持主或从操作,动态切换。支持多主模式,全双工或半双工同步传输,支持基本的 SD 卡和 MMC 模式。可编程的时钟极性和相位,数据位宽提供 8 或 16 位选择,可靠通信的硬件 CRC 产生/校验,支持 DMA 操作连续通讯。

#### 1.4.18 I2C 总线

芯片提供 2 个 I2C 总线接口, 能够工作于多主机模式或从模式, 完成所有 I2C 总线特定的时序、协议、仲裁等。支持标准和快速两种通讯速度, 同时与 SMBus 2. 0 兼容。

I2C 接口提供 7 位或 10 位寻址, 并且在 7 位从模式时支持双从地址寻址。内置了硬件 CRC 发生器/校验器。可以使用 DMA 操作并支持 SMBus 总线 2.0 版/PMBus 总线。

#### 1.4.19 控制器区域网络(CAN)

芯片提供 1 组 CAN 接口,兼容规范 2. 0A 和 2. 0B(主动),波特率高达 1Mbits/s,支持时间触发通信功能,支持 CAN FD 协议,和传统 CAN 最大区别是速率可变,数据 bit 率最高 8Mbps。可以接收和发送 11 位标识符的标准帧,也可以接收和发送 29 位标识符的扩展帧。具有 3 个发送邮箱和 2 个 3 级深度接收 FIFO。

#### 1.4.20 通用串行总线 USB2.0 全速主机/设备控制器(USBFS)

USB2.0 全速主机控制器和设备控制器(USBFS),遵循 USB2.0 Full speed 标准,支持 BC 充电协议。提供 8 个可配置的 USB 设备端点及一组主机端点。支持控制/批量/同步/中断传输,双缓冲区机制,USB 总线挂起/恢复操作,并提供待机/唤醒功能。USBFS 模块专用的 48MHz 时钟由内部主 PLL 分频直接产生(PLL 必须为 96MHz 或 72MHz 或 48MHz)。

#### 1.4.21 USB PD及 Type-C 控制器(USB PD)

内置 USB Power Delivery 控制器和 PD 收发器 PHY,支持 USB Type-C 主从检测,自动 BMC 编解码和 CRC,硬件边沿控制,支持 USB PD2.0 和 PD3.0 电力传输控制,支持快充,支持 UFP/PD 受电端 Sink和 DFP/PD 供电端 Source 应用、DRP 应用以及动态切换,部分型号内置可控 Rd 下拉电阻,支持 PDUSB。

外加 Type-C/PD 高压接口芯片 CH211 可实现 28V 直接供电、CC 引脚 28V 耐压以及内置 Type-C 规范定义的可控 Rd 下拉电阻 5K1。

#### 1.4.22 通用输入输出接口(GPIO)

系统提供了 4 组 GPI0 端口,共 37 个 GPI0 引脚。每个引脚都可以由软件配置成输出(推挽或开漏)、输入(带或不带上拉和下拉)或复用的外设功能端口。多数 GPI0 引脚都与数字或模拟的复用外设共用。除了具有模拟输入功能的端口,所有 GPI0 引脚都有较大电流驱动能力。提供锁定机制冻结 I0 配置,以避免意外的写入 I/0 寄存器。

系统中大部分 10 引脚电源由  $V_{10}$  提供,通过改变  $V_{10}$  供电将改变 10 引脚输出电平高值来适配外部通讯接口电平。具体引脚请参考引脚描述。

#### 1.4.23 运放/比较器(OPA)

芯片内置 1 组运放(OPA),也可用作电压比较器,其输入可通过更改配置对多个通道进行选择,支持多通道自动轮询,包括可编程增益运放(PGA)的放大倍数选择,其输出可通过更改配置对 5 个通道进行选择,内部关联到 ADC 通道。支持将外部模拟小信号放大送入 ADC 以实现小信号 ADC 转换。

#### 1.4.24 电压比较器 (CMP)

芯片内置 3 组轨到轨模拟电压比较器,支持两通道自动轮询,可选迟滞特性,电压比较结果由 GP10

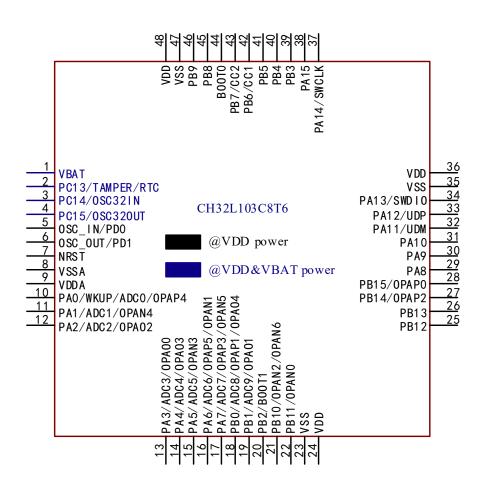
输出或者内部直接接入 TIM2 的 CH1~CH3 的输入通道实现触发。

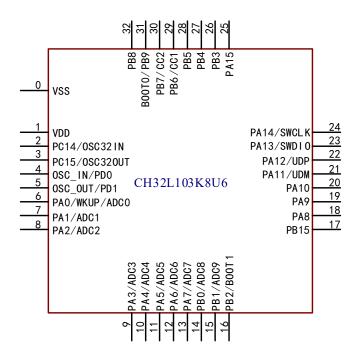
1.4.25 串行 2 线调试接口(2-wire SDI Serial Debug Interface)

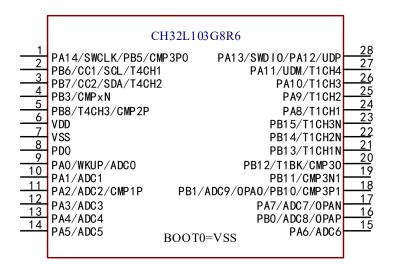
内核自带一个串行 2 线调试的接口(SDI),包括 SWDIO 和 SWCLK 引脚。系统上电或复位后默认调试接口引脚功能开启,主程序运行后可以根据需要关闭 SDI。

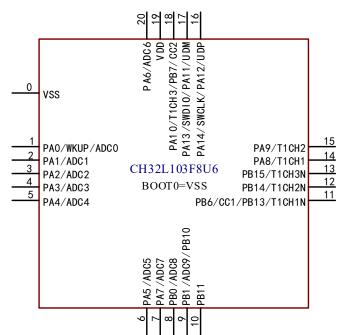
# 第2章 引脚信息

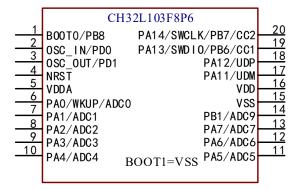
#### 2.1 引脚排列











# 注: 引脚图中复用功能为缩写。

示例: ADC:ADC\_ (ADCO:ADC\_INO)

T:TIME\_ (T1CH3:TIM1\_CH3, T1CH1N:TIM1\_CH1N, T1BK:TIM1\_BKIN)

OPA:OPA\_ (OPAP4:OPA\_P4, OPAN4:OPA\_N4, OPAO2:OPA\_02)

UDP: USBDP UDM: USBDM

# 2.2 引脚描述

注意,下表中的引脚功能描述针对的是所有功能,不涉及具体型号产品。不同型号之间外设资源有差 异,查看前请先根据产品型号资源表确认是否有此功能。

表 2-1 QFN20/QS0P28/QFN32/LQFP48 引脚定义

Ē	引脚:	编号							
QFN20	QS0P28	QFN32	LQFP48	引脚 名称	引脚 类型 <sup>⑴</sup>	I/0 电平	主功能(复位后)	默认复用功能	重映射功能 <sup>仰</sup>
_	_	_	1	$V_{BAT}$	Р	_	$V_{BAT}$		
_	_	_	2	PC13- TAMPER-RTC <sup>(2)</sup>	1/0	-	PC13 <sup>(3)</sup>	TAMPER RTC	
_	_	2	3	PC14- OSC32_IN <sup>(2)</sup>	1/0/A	_	PC14 <sup>(3)</sup>	0SC32_IN	
_	_	3	4	PC15- OSC32_OUT (2)	1/0/A		PC15 <sup>(3)</sup>	0SC32_0UT	
-	8	4	5	OSC_IN	I/0/A	_	OSC_IN		PDO <sup>(4)</sup> USART3_TX_3 USART3_RX_2 CAN_RX_3
-	_	5	6	OSC_OUT	I/0/A	_	OSC_OUT		PD1 <sup>(4)</sup> USART3_TX_2 USART3_RX_3 CAN_TX_3
_		_	7	NRST	I	_	NRST		
_	_	_	8	$V_{\sf SSA}$	Р	_	$V_{SSA}$		
_	_	_	9	$V_{DDA}$	Р	-	$V_{DDA}$		
1	9	6	10	PAO-WKUP	1/0/A	_	PAO	WKUP ADC_INO TIM2_CH1_ETR USART2_CTS OPA_P4	TIM2_CH1_ETR_2 USART2_CTS_2 USART2_CTS_3
2	10	7	11	PA1	1/0/A	_	PA1	ADC_IN1 TIM2_CH2 USART2_RTS OPA_N4	TIM1_CH1_2 TIM1_CH1_3 TIM2_CH2_2 TIM1_CH2N_5 USART2_RTS_2 USART2_RTS_3
3	11	8	12	PA2	I/0/A	-	PA2	ADC_IN2 CMP1_P0 OPA_02 TIM2_CH3 USART2_TX	TIM1_CH4_4 TIM2_CH2_4 TIM2_CH2_5 TIM2_CH3_1 USART1_CTS_2
4	12	9	13	PA3	1/0/A	-	PA3	ADC_IN3 OPA_00 TIM2_CH4	TIM1_ETR_3 TIM1_CH4_5 TIM2_CH1_ETR_4

QFN20	脚 8ZdOSD	编号 ZENJO	LQFP48	引脚 名称	引脚 类型 <sup>⑴</sup>	I/0 电平	主功能(复位后)	默认复用功能	重映射功能 <sup>⑴)</sup>
								USART2_RX	TIM2_CH4_1 USART1_CK_2
5	13	10	14	PA4	I/0/A	-	PA4	ADC_IN4 OPA_03 USART2_CK SPI1_NSS	TIM2_CH4_7 USART1_TX_2 USART1_RX_3 USART2_CK_2 USART2_CK_3
6	14	11	15	PA5	1/0/A	-	PA5	ADC_IN5 SPI1_SCK OPA_N3	TIM2_CH3_7 USART1_TX_3 USART1_RX_2 USART4_TX_1
20	15	12	16	PA6	I/O/A	_	PA6	ADC_IN6 TIM3_CH1 SPI1_MISO OPA_N1 OPA_P5	TIM1_BKIN_1 TIM2_CH4_4 TIM2_CH4_5 USART1_CK_3 USART1_CK_4 USART4_CK_1
7	17	13	17	PA7	I/0/A	-	PA7	SPI1_MOSI ADC_IN7 TIM3_CH2 OPA_N5 OPA_P3	TIM1_CH1N_1 TIM1_CH2_2 TIM1_CH2_3 USART4_CTS_1
8	16	14	18	PB0	I/0/A	-	PB0	ADC_IN8 TIM3_CH3 USART4_TX CMP1_OUTO OPA_P1 OPA_O4	TIM1_CH2N_1 TIM1_CH2N_2 TIM1_CH2N_3 TIM3_CH3_1
9	18	15	19	PB1 <sup>(7) (8)</sup>	1/0/A	ı	PB1	ADC_IN9 TIM3_CH4 USART4_RX CMP1_NO OPA_O1	TIM1_CH1_5 TIM1_CH4_2 TIM1_CH4_3 TIM1_CH2N_4 TIM1_CH3N_1 TIM3_CH4_1
-	_	16	20	PB2 <sup>(5)</sup>	1/0/A	FT	PB2 B00T1 <sup>(5)</sup>	USART4_CK CMP1_P1	LPT_OUT_1
9	18	-	21	PB10 <sup>(7) (8)</sup>	I/0/A	FT	PB10	USART3_TX I2C2_SCL CMP1_OUT1 CMP3_P1 OPA_N2	TIM4_CH1_1 TIM2_CH3_2 TIM2_CH3_3

QFN20	m	编号 ZENJO	LQFP48	引脚 名称	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	I/0 电平	主功能	默认复用功能	重映射功能(10)
QFI	080	QF.	LOF	<b>台</b>	<b>安全</b>	电平 	(复位后)		
								OPA_N6	
10	19	-	22	PB11	1/0/A	FT	PB11	CMP2_OUT1 CMP3_N1 OPA_NO USART3_RX I2C2_SDA	TIM1_CH1N_2 TIM1_CH1N_3 TIM2_CH4_2 TIM2_CH4_3 TIM4_CH2_1 USART1_TX_4 I2C1_SDA_3
0	7	0	23	$V_{\text{SS}}$	Р	_	$V_{\text{ss}}$		
19	6	1	24	$V_{ extsf{DD}}$	Р	-	$V_{ exttt{DD}}$		
_	20	_	25	PB12	I/0/A	FT	PB12	CMP3_OUT1 TIM1_BKIN LPT_IN1 USART3_CK I2C2_SMBA SPI2_NSS	TIM1_CH3_4 TIM2_CH3_4 TIM2_CH3_5 USART1_TX_5 USART3_CK_2 USART3_CK_3 SPI1_NSS_3
11	21	_	26	PB13 <sup>(8)</sup>	1/0	FT	PB13	TIM1_CH1N LPT_IN2 USART3_CTS SPI2_SCK	USART3_CTS_2 USART3_CTS_3
12	22	-	27	PB14	I/0/A	FT	PB14	TIM1_CH2N LPT_ETR USART3_RTS SPI2_MISO OPA_P2	USART3_RTS_2 USART3_RTS_3
13	23	17	28	PB15	1/0/A	FT	PB15	TIM1_CH3N LPT_OUT SPI2_MOSI OPA_PO	
14	24	18	29	PA8	1/0	FT	PA8	MCO TIM1_CH1 USART1_CK	TIM1_CH1_1 USART1_CK_1
15	25	19	30	PA9	1/0	FT	PA9	TIM1_CH2 USART1_TX	T I M1_CH2_1
18	26	20	31	PA10 <sup>(8)</sup>	1/0	FT	PA10	TIM1_CH3 USART1_RX	T I M1_CH3_1
17	27	21	32	PA11 <sup>(8)</sup>	1/0/A	FT	PA11	TIM1_CH4	T I M1_CH4_1

QFN20	脚 8ZdOSD	编号 ZENJO	LQFP48	引脚名称	引脚 类型 <sup>⑴</sup>	I/0 电平	主功能(复位后)	默认复用功能	重映射功能 <sup>⑴)</sup>
								USART1_CTS USBDM CAN_RX	USART1_CTS_1 USART2_TX_2 USART2_RX_3
16	28	22	33	PA12 <sup>(7) (8)</sup>	I/0/A	FT	PA12	USART1_RTS USBDP CAN_TX TIM1_ETR	USART1_RTS_1 TIM1_ETR_1 TIM1_BKIN_4 TIM1_BKIN_5 TIM2_CH1_ETR_5 TIM2_CH1_ETR_7 USART1_RX_5 USART2_TX_3 USART2_RX_2 I2C1_SDA_2 SPI1_NSS_2
17		23	34	PA13 <sup>(7) (8)</sup>	1/0	FT	SWDIO		TIM1_ETR_5 TIM1_BKIN_2 TIM1_BKIN_3 USART1_RTS_2 USART1_RTS_4 I2C1_SCL_2
_	_		35	V <sub>ss</sub>	Р	_	Vss		
-	_		36	V <sub>DD</sub>	Р	_	$V_{ extsf{DD}}$		
16	1	24	37	PA14 <sup>(7) (8)</sup>	1/0	FT	SWCLK		TIM1_CH3_2 TIM1_CH3_3 TIM1_CH1N_4 TIM1_CH1N_5 USART1_CTS_4
_	ı	25	38	PA15	1/0	FT	PA15		TIM2_CH1_ETR_1 TIM2_CH1_ETR_3 USART4_RTS_1 SPI1_NSS_1
_	4	26	39	PB3	1/0/A	FT	PB3	CMP1_N1 CMP2_N0 CMP3_N0 USART4_CTS	TIM2_CH2_1 TIM2_CH2_3 SPI1_SCK_1
_	_	27	40	PB4	1/0/A	FT	PB4	CMP3_OUTO USART4_RTS	TIM3_CH1_1 SPI1_MISO_1
-	1	28	41	PB5 <sup>(7)</sup>	1/0/A	FT	PB5	I 2C1_SMBA CMP2_OUTO CMP3_PO	LPT_IN1_1 TIM3_CH2_1 USART4_RX_1 I2C1_SMBA_2

5	脚	编号							
QFN20	QS0P28	QFN32	LQFP48	引脚 名称	引脚 类型 <sup>⑴</sup>	I/0 电平	主功能(复位后)	默认复用功能	重映射功能(10)
									12C1_SMBA_3
									SPI1_MOSI_1
									LPT_ETR_1
									USART1_TX_1
								TIM4_CH1	USART1_CK_5
11	2	29	42	PB6 <sup>(8)</sup>	I/0/A	FT	PB6	I 2C1_SCL	SPI1_SCK_2
								CC1	SPI1_SCK_3
								CMP2_P1	TIM1_ETR_2
									TIM1_ETR_4
									TIM1_CH3_5
									LPT_IN2_1
									USART1_RX_1
								TIM4_CH2	USART1_CTS_3
18	3	30	43	PB7 <sup>(8)</sup>	I/0/A	FT	PB7	I 2C1_SDA	USART1_CTS_5
								CC2	SPI1_MOSI_2
								CMP2_N1	SPI1_MOSI_3
									TIM1_CH1_4
									TIM1_CH3N_5
_	_	31	44	B00T0 <sup>(6)</sup>	I	_	ВООТО		
									T1M4_CH3_1
									USART1_RTS_3
									USART1_RTS_5
								TIM4_CH3	SPI1_MISO_2
-	5	32	45	PB8	I/0/A	FT	PB8	CMP2_P0	SPI1_MISO_3
								0 m 2_1 0	CAN_RX_2
									TIM1_CH2_4
									TIM1_CH2_5
									T1M2_CH2_7
									TIM4_CH4_1
									USART1_RX_4
									I2C1_SCL_3
-	-	31	46	PB9 <sup>(6)</sup>	I/0/A	FT	PB9	TIM4_CH4	CAN_TX_2
									T1M1_CH3N_2
									TIM1_CH3N_3
									TIM1_CH3N_4
_	_	_	47	Vss	Р	_	Vss		
_	_	_	48	$V_{ extsf{DD}}$	Р	_	$V_{ exttt{DD}}$		

# 表 2-2 TSSOP20 引脚定义

引脚 编 OZdOSS1	引脚 名称	引脚 类型 <sup>⑴</sup>	I/0 电平	主功能(复位后)	默认复用功能	重映射功能 <sup>⑴)</sup>
2	OSC_IN	1/0/A	_	OSC_IN		PDO <sup>(4)</sup> USART3_TX_3 USART3_RX_2 CAN_RX_3
3	OSC_OUT	1/0/A	_	OSC_OUT		PD1 <sup>(4)</sup> USART3_TX_2 USART3_RX_3 CAN_TX_3
4	NRST	I	_	NRST		
5	$V_{\text{DDA}}$	Р	_	$V_{\text{DDA}}$		
6	PAO-WKUP	1/0/A	_	PAO	WKUP ADC_INO TIM2_CH1_ETR USART2_CTS OPA_P4	TIM2_CH1_ETR_2 USART2_CTS_2 USART2_CTS_3
7	PA1	1/0/A	-	PA1	ADC_IN1 TIM2_CH2 USART2_RTS OPA_N4	TIM1_CH1_2 TIM1_CH1_3 TIM2_CH2_2 TIM1_CH2N_5 USART2_RTS_2 USART2_RTS_3
8	PA2	1/0/A	-	PA2	ADC_IN2 CMP1_P0 OPA_02 TIM2_CH3 USART2_TX	TIM1_CH4_4 TIM2_CH2_4 TIM2_CH2_5 TIM2_CH3_1 USART1_CTS_2
9	PA3	1/0/A	_	PA3	ADC_IN3 OPA_00 TIM2_CH4 USART2_RX	TIM1_ETR_3 TIM1_CH4_5 TIM2_CH1_ETR_4 TIM2_CH4_1 USART1_CK_2
10	PA4	1/0/A	-	PA4	ADC_IN4 OPA_03 USART2_CK SPI1_NSS	TIM2_CH4_7 USART1_TX_2 USART1_RX_3 USART2_CK_2 USART2_CK_3

引脚 编号 0ZdOSS1	引脚 名称	引脚 类型 <sup>⑴</sup>	I/0 电平	主功能(复位后)	默认复用功能	重映射功能 <sup>⑴)</sup>
11	PA5	1/0/A	_	PA5	ADC_IN5 SPI1_SCK OPA_N3	TIM2_CH3_7 USART1_TX_3 USART1_RX_2 USART4_TX_1
12	PA6	1/0/A	_	PA6	ADC_IN6 TIM3_CH1 SPI1_MISO OPA_N1 OPA_P5	TIM1_BKIN_1 TIM2_CH4_4 TIM2_CH4_5 USART1_CK_3 USART1_CK_4 USART4_CK_1
13	PA7	1/0/A	_	PA7	SPI1_MOSI ADC_IN7 TIM3_CH2 OPA_N5 OPA_P3	TIM1_CH1N_1 TIM1_CH2_2 TIM1_CH2_3 USART4_CTS_1
14	PB1	1/0/A	-	PB1	ADC_IN9 TIM3_CH4 USART4_RX CMP1_N0 OPA_01	TIM1_CH1_5 TIM1_CH4_2 TIM1_CH4_3 TIM1_CH2N_4 TIM1_CH3N_1 TIM3_CH4_1
15	V <sub>ss</sub>	Р	_	Vss		
16	V <sub>DD</sub>	Р	_	V <sub>DD</sub>		
17	PA11	1/0/A	FT	PA11	TIM1_CH4 USART1_CTS USBDM CAN_RX	TIM1_CH4_1 USART1_CTS_1 USART2_TX_2 USART2_RX_3
18	PA12	1/0/A	FT	PA12	USART1_RTS USBDP CAN_TX TIM1_ETR	USART1_RTS_1 TIM1_ETR_1 TIM1_BKIN_4 TIM1_BKIN_5 TIM2_CH1_ETR_5 TIM2_CH1_ETR_7 USART1_RX_5 USART2_TX_3 USART2_RX_2 I2C1_SDA_2 SPI1_NSS_2

引脚 编号 0ZdoSS1	引脚 名称	引脚 类型 <sup>⑴</sup>	I/0 电平	主功能(复位后)	默认复用功能	重映射功能 <sup>⑴)</sup>
19	PA13 <sup>(9)</sup>	1/0	FT	SWDIO		TIM1_ETR_5 TIM1_BKIN_2 TIM1_BKIN_3 USART1_RTS_2 USART1_RTS_4 I2C1_SCL_2
20	PA14 <sup>(9)</sup>	1/0	FT	SWCLK		TIM1_CH3_2 TIM1_CH3_3 TIM1_CH1N_4 TIM1_CH1N_5 USART1_CTS_4
19	PB6 <sup>(9)</sup>	1/0/A	FT	PB6	TIM4_CH1 I2C1_SCL CC1 CMP2_P1	LPT_ETR_1 USART1_TX_1 USART1_CK_5 SPI1_SCK_2 SPI1_SCK_3 TIM1_ETR_2 TIM1_ETR_4 TIM1_CH3_5
20	PB7 <sup>(9)</sup>	1/0/A	FT	PB7	TIM4_CH2 I2C1_SDA CC2 CMP2_N1	LPT_IN2_1 USART1_RX_1 USART1_CTS_3 USART1_CTS_5 SPI1_MOSI_2 SPI1_MOSI_3 TIM1_CH1_4 TIM1_CH3N_5
	B00T0 <sup>(6)</sup>	ı	_	В00Т0		
1	PB8 <sup>(6)</sup>	1/0/A	FT	PB8	TIM4_CH3 CMP2_P0	TIM4_CH3_1 USART1_RTS_3 USART1_RTS_5 SPI1_MISO_2 SPI1_MISO_3 CAN_RX_2 TIM1_CH2_4 TIM1_CH2_5 TIM2_CH2_7

注1:表格缩写解释

I = TTL/CMOS 电平斯密特输入; 0 = CMOS 电平三态输出;

- A = 模拟信号输入或输出; P = 电源; FT = 耐受5V;
- 注2: Voo和Vbar均可连接内部模拟开关为备份区域以及PC13、PC14和PC15引脚供电,这个模拟开关只能够通过有限的电流(3mA)。当由Voo供电时: PC14和PC15可用于GP10或LSE引脚、PC13可作为通用I/0口、TAMPER引脚、RTC校准时钟、RTC闹钟或秒输出; PC13、PC14和PC15作为GP10输出脚时只能工作在2MHz模式下,最大驱动负载为30pF,并且不能作为电流源(如驱动LED)。而当由Vbar供电时: PC14和PC15只能用于LSE引脚、PC13可作为TAMPER引脚、RTC闹钟或秒输出。
- 注3: 这些引脚在备份区域第一次上电时处于主功能状态下,之后即使复位,这些引脚的状态由备份区域寄存器控制(这些寄存器不会被主复位系统所复位)。关于如何控制这些10口的具体信息,请参考CH32L103RM手册的电池备份区域和BKP寄存器的相关章节。
- 注4: 对于CH32L103C8T6芯片,引脚5和引脚6在芯片复位后默认配置为0SC\_IN和0SC\_OUT功能脚,软件可以重新设置这两个引脚为PD0和PD1功能;对于CH32L103K8U6芯片,引脚4和引脚5在芯片复位后默认配置为0SC\_IN和0SC\_OUT功能脚,软件可以重新设置这两个引脚为PD0和PD1功能;对于CH32L103G8R6芯片,引脚8在芯片复位后默认配置为0SC\_IN功能脚,软件可以重新设置这两个引脚为PD0功能;对于CH32L103F8P6芯片,引脚2和引脚3在芯片复位后默认配置为0SC\_IN和0SC\_OUT功能脚,软件可以重新设置这两个引脚为PD0和PD1功能。更多详细信息请参考CH32L103RM手册的复用功能I/0章节和调试设置章节。
- 注5: B00T0引脚未引出的芯片,在内部将下拉到GND。B00T0引脚引出,但B00T1/PB2引脚未引出的芯片, 内部B00T1/PB2引脚将下拉到GND。此时如果进入低功耗模式配置10口状态时,建议B00T1/PB2引脚 使用输入下拉模式防止产生额外电流。
- 注6: 对于CH32L103K8U6芯片,B00T0和PB9引脚在芯片内部短接合封,此时PB9引脚不再支持耐压5V;对于CH32L103F8P6芯片,B00T0和PB8引脚在芯片内部短接合封,此时PB8引脚不再支持耐压5V。建议外接4.7K下拉电阻,确保上电期间B00T0为低电平,以便进入程序闪存存储器自举模式,正常工作后PB9、PB3和PB8引脚根据需要可以用于输出。
- 注7: 对于CH32L103G8R6芯片, PA14和PB5引脚在芯片内部短接合封, 禁止将两个I0均配置为输出功能; PB1和PB10引脚在芯片内部短接合封, 此时PB10引脚不再支持耐压5V, 禁止将两个I0均配置为输出功能: PA12和PA13引脚在芯片内部短接合封, 禁止将两个I0均配置为输出功能。
- 注8: 对于CH32L103F8U6芯片, PB1和PB10引脚在芯片内部短接合封,此时PB10引脚不再支持耐压5V,禁止将两个I0均配置为输出功能; PB6和PB13引脚在芯片内部短接合封,禁止将两个I0均配置为输出功能; PA12和PA14引脚在芯片内部短接合封,禁止将两个I0均配置为输出功能; PA10和PB7引脚在芯片内部短接合封,禁止将两个I0均配置为输出功能; PA10和PB7引脚在芯片内部短接合封,禁止将两个I0均配置为输出功能。
- 注9:对于CH32L103F8P6芯片,PA13和PB6引脚在芯片内部短接合封,禁止将两个I0均配置为输出功能; PA14和PB7引脚在芯片内部短接合封,禁止将两个I0均配置为输出功能。
- 注10: 重映射功能下划线后的数值表示AFIO寄存器中相对应位的配置值。例如: CAN\_RX\_2表示AFIO寄存器相应位配置为10b。

# 2.3 引脚复用功能

注意,下表中的引脚功能描述针对的是所有功能,不涉及具体型号产品。不同型号之间外设资源有差异,查看前请先根据产品型号资源表确认是否有此功能。 表 2−3 引脚复用和重映射功能

复用 引脚	ADC	TIM1	T1M2/3/4	USART	CMP	SYS	120	SPI	CAN	USB	OPA	LPTIM
PA0	ADC_INO		TIM2_CH1_ETR TIM2_CH1_ETR_2	USART2_CTS USART2_CTS_2 USART2_CTS_3		WKUP					OPA_P4	
PA1	ADC_IN1	TIM1_CH1_2 TIM1_CH1_3 TIM1_CH2N_5	TIM2_CH2 TIM2_CH2_2	USART2_RTS USART2_RTS_2 USART2_RTS_3							OPA_N4	
PA2	ADC_IN2	TIM1_CH4_4	TIM2_CH2_4 TIM2_CH2_5 TIM2_CH3 TIM2_CH3_1	USART1_CTS_2 USART2_TX	CMP1_P0						0PA_02	
PA3	ADC_IN3	TIM1_ETR_3 TIM1_CH4_5	TIM2_CH1_ETR_4 TIM2_CH4 TIM2_CH4_1	USART1_CK_2 USART2_RX							0PA_00	
PA4	ADC_IN4		T1M2_CH4_7	USART1_TX_2 USART1_RX_3 USART2_CK USART2_CK_2 USART2_CK_3				SPI1_NSS			0PA_03	
PA5	ADC_IN5		T1M2_CH3_7	USART1_TX_3 USART1_RX_2 USART4_TX_1				SPI1_SCK			OPA_N3	
PA6	ADC_IN6	TIM1_BKIN_1	TIM2_CH4_4 TIM2_CH4_5 TIM3_CH1	USART1_CK_3 USART1_CK_4 USART4_CK_1				SPI1_MISO			0PA_N1 0PA_P5	
PA7	ADC_IN7	TIM1_CH2_2 TIM1_CH2_3 TIM1_CH1N_1	TIM3_CH2	USART4_CTS_1				SPI1_MOSI			OPA_N5 OPA_P3	
PA8		TIM1_CH1 TIM1_CH1_1		USART1_CK USART1_CK_1		MCO						
PA9		TIM1_CH2 TIM1_CH2_1		USART1_TX								
PA10		TIM1_CH3 TIM1_CH3_1		USART1_RX								
PA11		TIM1_CH4 TIM1_CH4_1		USART1_CTS USART1_CTS_1 USART2_TX_2					CAN_RX	USBDM		

复用 引脚	ADC	TIM1	T1M2/3/4	USART	CMP	SYS	120	SPI	CAN	USB	OPA	LPTIM
				USART2_RX_3								
PA12		TIM1_BKIN_4 TIM1_BKIN_5 TIM1_ETR TIM1_ETR_1	TIM2_CH1_ETR_5 TIM2_CH1_ETR_7	USART1_RX_5 USART1_RTS USART1_RTS_1 USART2_TX_3 USART2_RX_2			12C1_SDA_2	SPI1_NSS_2	CAN_TX	USBDP		
PA13		TIM1_ETR_5 TIM1_BKIN_2 TIM1_BKIN_3		USART1_RTS_2 USART1_RTS_4		SWDIO	12C1_SCL_2					
PA14		TIM1_CH3_2 TIM1_CH3_3 TIM1_CH1N_4 TIM1_CH1N_5		USART1_CTS_4		SWCLK						
PA15			TIM2_CH1_ETR_1 TIM2_CH1_ETR_3	USART4_RTS_1				SPI1_NSS_1				
PB0	ADC_IN8	TIM1_CH2N_1 TIM1_CH2N_2 TIM1_CH2N_3	TIM3_CH3 TIM3_CH3_1	USART4_TX	CMP1_OUTO						0PA_P1 0PA_04	
PB1	ADC_IN9	TIM1_CH1_5 TIM1_CH4_2 TIM1_CH4_3 TIM1_CH2N_4 TIM1_CH3N_1	TIM3_CH4 TIM3_CH4_1	USART4_RX	CMP1_NO						0PA_01	
PB2				USART4_CK	CMP1_P1		B00T1					LPT_OUT_1
PB3			TIM2_CH2_1 TIM2_CH2_3	USART4_CTS	CMP1_N1 CMP2_NO CMP3_NO			SPI1_SCK_1				
PB4			T I M3_CH1_1	USART4_RTS	CMP3_OUTO			SPI1_MISO_1				
PB5			TIM3_CH2_1	USART4_RX_1	CMP2_OUTO CMP3_P0		12C1_SMBA   12C1_SMBA_2   12C1_SMBA_3	SPI1_MOSI_1				LPT_IN1_1
PB6		TIM1_ETR_2 TIM1_ETR_4 TIM1_CH3_5	TIM4_CH1	USART1_TX_1 USART1_CK_5	CMP2_P1		1201_SCL	SPI1_SCK_2 SPI1_SCK_3		CC1		LPT_ETR_1
PB7		TIM1_CH1_4 TIM1_CH3N_5	TIM4_CH2	USART1_RX_1 USART1_CTS_3 USART1_CTS_5	CMP2_N1		I 2C1_SDA	SPI1_MOSI_2 SPI1_MOSI_3		CC2		LPT_IN2_1
PB8		TIM1_CH2_4 TIM1_CH2_5	TIM4_CH3 TIM4_CH3_1 TIM2_CH2_7	USART1_RTS_3 USART1_RTS_5	CMP2_P0			SPI1_MISO_2 SPI1_MISO_3	CAN_RX_2			

复用 引脚	ADC	TIM1	T1M2/3/4	USART	CMP	SYS	120	SPI	CAN	USB	OPA	LPTIM
PB9		TIM1_CH3N_2 TIM1_CH3N_3 TIM1_CH3N_4	TIM4_CH4 TIM4_CH4_1	USART1_RX_4			12C1_SCL_3		CAN_TX_2			
PB10			TIM4_CH1_1 TIM2_CH3_2 TIM2_CH3_3	USART3_TX	CMP1_OUT1 CMP3_P1		1202_SCL				OPA_N2 OPA_N6	
PB11		TIM1_CH1N_2 TIM1_CH1N_3	TIM2_CH4_2 TIM2_CH4_3 TIM4_CH2_1	USART1_TX_4 USART3_RX	CMP2_OUT1 CMP3_N1		12C1_SDA_3 12C2_SDA				OPA_NO	
PB12		TIM1_CH3_4 TIM1_BKIN	TIM2_CH3_4 TIM2_CH3_5	USART1_TX_5 USART3_CK USART3_CK_2 USART3_CK_3	CMP3_OUT1		12C2_SMBA	SPI1_NSS_3 SPI2_NSS				LPT_IN1
PB13		TIM1_CH1N		USART3_CTS USART3_CTS_2 USART3_CTS_3				SP12_SCK				LPT_IN2
PB14		TIM1_CH2N		USART3_RTS USART3_RTS_2 USART3_RTS_3				SPI2_MISO			OPA_P2	LPT_ETR
PB15		TIM1_CH3N						SP12_MOS1			OPA_P0	LPT_OUT
PC13						RTC TAMPER						
PC14						0SC32_IN						
PC15						0SC32_0UT						
PD0				USART3_TX_3 USART3_RX_2		OSC_IN			CAN_RX_3			
PD1				USART3_TX_2 USART3_RX_3		OSC_OUT			CAN_TX_3			

# 第3章 电气特性

# 3.1 测试条件

除非特殊说明和标注, 所有电压都以 Vss 为基准。

所有最小值和最大值将在最坏的环境温度、供电电压和时钟频率条件下得到保证。典型数值是基 于常温 25℃和 V<sub>D</sub> = 3.3V 环境下用于设计指导。

对于通过综合评估、设计模拟或工艺特性得到的数据,不会在生产线进行测试。在综合评估的基 础上,最小和最大值是通过样本测试后统计得到。除非特殊说明为实测值,否则特性参数以综合评估 或设计保证。

供电方案:

图 3-1 常规供电典型电路  $V_{\text{BAT}}$ 1.8-3.6V  $V_{\text{DD}}$  $V_{DDx}$ 4.7uF 0.1uF  $V_{SSx}$  $V_{DD}$  $V_{DDA}$ 0.1uF  $V_{SSA}$ 

# 3.2 绝对最大值

临界或者超过绝对最大值将可能导致芯片工作不正常甚至损坏。

表 3-1 绝对最大值参数表

符号	描述	最小值	最大值	单位
T <sub>A</sub>	工作时的环境温度	-40	85	°C
Ts	存储时的环境温度	-40	125	°C
$V_{DD}$ – $V_{SS}$	外部主供电电压(包含 Voda和 Vod)	-0. 3	4. 0	V
V <sub>IN</sub>	FT(耐受 5V)引脚上的输入电压	V <sub>ss</sub> -0. 3	5. 5	V
VIN	其他引脚上的电压	V <sub>ss</sub> -0. 3	V <sub>DD</sub> +0. 3	V
$ \triangle V_{DD_x} $	主供电引脚各 V∞之间的电压差		50	mV
$ \triangle V_{ss_x} $	不同接地引脚之间的电压差		50	mV
V	普通 I/O 引脚的 ESD 静电放电电压(HBM)	4K		V
V <sub>ESD</sub> (HBM)	USB 引脚的 ESD 静电放电电压(HBM)	4K		V
I <sub>VDD</sub>	经过 V <sub>DD</sub> /V <sub>DDA</sub> 电源线的总电流(供应电流)		150	mA

I <sub>Vss</sub>	经过 Vss 地线的总电流(流出电流)	150	mA
110	任意 1/0 和控制引脚上的灌电流	25	mA
	任意 1/0 和控制引脚上的源电流	-25	mA
	NRST 引脚注入电流	+/-5	mA
I <sub>INJ (PIN)</sub>	HSE 的 OSC_IN 引脚和 LSE 的 OSC_IN 引脚注入电流	+/-5	mA
	其他引脚的注入电流	+/-5	mA
Σ I INJ (PIN)	所有 I0 和控制引脚的总注入电流	+/-25	mA

# 3.3 电气参数

# 3.3.1 工作条件

表 3-2 通用工作条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
FHCLK	内部 HB 时钟频率			96	MHz
F <sub>PCLK1</sub>	内部 PB1 时钟频率			96	MHz
F <sub>PCLK2</sub>	内部 PB2 时钟频率			96	MHz
$V_{DD}$	标准工作电压		1. 8	3. 6	V
V DD		使用 USB	3. 0	3. 6	, <b>'</b>
l v	模拟部分工作电压(未使用 ADC)		2. 0	3. 6	V
$V_{ extsf{DDA}}$	模拟部分工作电压(使用 ADC)		2. 4	3. 6	\ \ \
<b>V</b> <sub>BAT</sub> <sup>(1)</sup>	备份单元工作电压	不能大于 V₪	1.8	3. 6	٧
T <sub>A</sub>	环境温度		-40	85	°C
TJ	结温度范围		-40	105	°C

注: 1. 电池到 VBAT 连线要尽可能的短。

# 表 3-3 上电和掉电条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
t <sub>VDD</sub>	V∞上升速率		0	8	ue/V
	Vm下降速率		70	∞	us/V

注: 电池到 VBAT 连线要尽可能的短。

#### 3.3.2 内置复位和电源控制模块特性

表 3-4 复位及电压监测 (PDR 选择高阈值档位)

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
		PLS[2:0] = 000(上升沿)		1. 75		٧
		PLS[2:0] = 000(下降沿)		1. 70		٧
		PLS[2:0] = 001(上升沿)		1. 93		V
		PLS[2:0] = 001(下降沿)		1. 87		V
<b>V</b> <sub>PVD</sub> (1)	可编程电压检测器的电	PLS[2:0] = 010(上升沿)		2. 14		V
V PVD	平选择	PLS[2:0] = 010(下降沿)		2. 08		V
		PLS[2:0] = 011(上升沿)		2. 35		٧
		PLS[2:0] = 011(下降沿)		2. 28		V
		PLS[2:0] = 100(上升沿)		2. 54		٧
		PLS[2:0] = 100(下降沿)		2. 46		٧

		PLS[2:0] = 101(上升沿)		2. 72		٧
		PLS[2:0] = 101(下降沿)		2. 63		٧
		PLS[2:0] = 110(上升沿)		2. 92		٧
		PLS[2:0] = 110(下降沿)		2. 83		٧
		PLS[2:0] = 111(上升沿)		3. 1		٧
		PLS[2:0] = 111(下降沿)		3. 01		٧
$V_{\sf PVDhyst}^{(1)}$	PVD 迟滞		0. 05	0. 08	0. 1	٧
V <sub>POR/PDR</sub> (2)	上电/掉电复位阈值	上升沿	1. 63	1. 73	1. 80	٧
V POR/PDR	上电/挥电复拟则阻 	下降沿	1. 50	1. 55	1. 65	٧
$V_{\sf PDRhyst}^{(2)}$	PDR 迟滞			180	300	mV
t <sub>RSTTEMPO</sub>	复位持续时间		6	6. 5	30	ms

注: 1. 设计参数;

2. 常温测试值。

#### 3.3.3 内置的参考电压

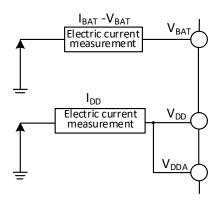
#### 表 3-5 内置参考电压

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V <sub>REFINT</sub>	内置参考电压	$T_A = -40^{\circ}C \sim 85^{\circ}C$	1. 17	1. 2	1. 23	٧
$T_{S\_vrefint}$	当读出内部参考电压时, ADC 的采样时间	建议慢速采样			20	us

#### 3.3.4 供电电流特性

电流消耗是多种参数和因素的综合指标,这些参数和因素包括工作电压、环境温度、I/0 引脚的负载、产品的软件配置、工作频率、I/0 脚的翻转速率、程序在存储器中的位置以及执行的代码等。电流消耗测量方法如下图:

图 3-2 电流消耗测量



# 微控制器处于下列条件:

常温  $V_{DD}$  = 3. 3V 情况下,测试时: R16\_PORT\_CC1 的位 CC1\_PD 和 R16\_PORT\_CC2 的位 CC2\_PD 均 = 0,所有 I/0 引脚配置为下拉输入,运行于高速内部 RC 振荡器 HSI,HSI=8M, $F_{PLCKI}=F_{HCLK}/2$ , $F_{PLCKZ}=F_{HCLK}$ ,使能或关闭所有外设时钟的功耗。

表 3-6 数据处理代码从 FLASH 中运行,设置 LDOTRIM[1:0]=10、LD0\_EC=0

符号	参数		条件		典型	值	畄/☆
付写	<b>少</b> 数	HSILP	PLLON	F <sub>HCLK</sub>	使能所有外设	关闭所有外设	単位
		0	1	96MHz	7. 46	4. 70	
		0	1	48MHz	5. 13	3. 77	
	노 (二 ## <del>-  </del>	0	1	8MHz	2. 23	1. 95	
	运行模式 下的供应	0	1	1MHz	1. 46	1. 43	
	电流	1	1	1MHz	1. 27	1. 24	mA
	<b>电</b> 流	0	0	8MHz	2. 14	1. 87	
		0	0	1MHz	1. 37	1. 34	
(1) (2)		1	0	1MHz	1. 19	1. 17	
DD ( )		0	1	96MHz	5. 58	2. 82	
	睡眠模式	0	1	48MHz	3. 52	2. 14	
	下的供应	0	1	8MHz	1. 74	1. 47	
	电流(此	0	1	1MHz	1. 40	1. 37	mA
	时外设供	1	1	1MHz	1. 21	1. 18	ША
	电和时钟	0	0	8MHz	1. 65	1. 38	
	保持)	0	0	1MHz	1. 31	1. 28	
		1	0	1MHz	1. 13	1.10	

注: 1. 以上为实测参数。

表 3-7-1 数据处理代码从 SRAM 中运行, FLASH 进入低功耗模式 (1), 设置 LD0TR IM [1:0]=10

<i>አ</i> ታ ロ	<del></del>		条件		典	型值	* /÷
符号	参数	HSILP	PLLON	F <sub>HCLK</sub> (3)	使能所有外设	关闭所有外设	単位
		0	1	96MHz	7. 08	4. 29	
		0	1	48MHz	3. 77	2. 37	
		0	1	8MHz	0. 91	0. 63	
		0	1	1MHz	0. 40	0. 37	
	运行模式	1	1	8MHz	0. 68	0. 46	
	下的供应	1	1	1MHz	0. 21	0. 17	mA
	电流	0	0	8MHz	0. 83	0. 56	
		0	0	1MHz	0. 31	0. 28	
l <sub>DD</sub> (2) (4)		1	0	1MHz	0. 13	0. 10	
		1	0	500KHz	0. 10	0. 08	
		1	0	125KHz	0. 07	0. 07	
	睡眠模式	0	1	96MHz	4. 60	1. 81	
	下的供应	0	1	48MHz	2. 52	1. 13	
	电流(此	0	1	8MHz	0. 72	0. 44	
	时外设供	0	1	1MHz	0. 38	0. 34	mA
	电和时钟	1	1	8MHz	0. 48	0. 25	
	保持)(4)	1	1	1MHz	0. 18	0. 15	

<sup>2.</sup> 当配置 CC1\_PD 和 CC2\_PD = 1 时, CH32L103K8U6 和 F8U6 芯片的电流消耗将在上述表格的基础上另加约 5uA; 其他 CH32L103 芯片配置 CC1\_PD 和 CC2\_PD = 1 且 PB6/CC1 和 PB7/CC2 引脚为下拉输入时, 其电流消耗将在上述表格的基础上另加约 5uA。

0	0	8MHz	0. 63	0. 35	
0	0	1MHz	0. 28	0. 26	
1	0	1MHz	0. 11	0. 07	
1	0	500KHz	0. 08	0. 07	
1	0	125KHz	0. 07	0. 06	

- 注: 1. 当 FLASH\_LP\_REG=1 且 FLASH\_LP=1 时, FLASH 进入低功耗模式。
  - 2. 以上为实测参数。
  - 3. 当 FHOLK 超过 16MHz 时,设置 LDO\_EC=0,否则默认设置 LDO\_EC=1。
- 4. 当配置 CC1\_PD 和 CC2\_PD = 1 时,CH32L103K8U6 和 F8U6 芯片的电流消耗将在上述表格的基础上另加约 5uA;其他 CH32L103 芯片配置 CC1\_PD 和 CC2\_PD = 1 且 PB6/CC1 和 PB7/CC2 引脚为下拉输入时,其电流消耗将在上述表格的基础上另加约 5uA。

表 3-7-2 数据处理代码从 SRAM 中运行, FLASH 不进入低功耗模式 (1), 设置 LDOTR IM [1:0]=10

符号	参数		条件		典	型值	单位
175	多奴	HSILP	PLLON	F <sub>HCLK</sub> (3)	使能所有外设	关闭所有外设	
		0	1	96MHz	7. 87	5. 09	
		0	1	48MHz	4. 68	3. 28	
		0	1	8MHz	1. 97	1. 69	
	运行模式	0	1	1MHz	1. 44	1. 40	
	下的供应	1	1	8MHz	1. 71	1. 47	mA
	电流	1	1	1MHz	1. 23	1. 20	
		0	0	8MHz	1. 85	1. 57	
		0	0	1MHz	1. 34	1. 31	
(2) (4)		1	0	1MHz	1. 16	1. 13	
l <sub>DD</sub> (2) (4)		0	1	96MHz	5. 64	2. 84	
	마프 마디 1# -1	0	1	48MHz	3. 56	2. 16	
	睡眠模式	0	1	8MHz	1. 75	1. 48	
	下的供应	0	1	1MHz	1. 41	1. 38	
	电流(此	1	1	8MHz	1. 51	1. 28	mA
	时外设供	1	1	1MHz	1. 21	1. 18	
	电和时钟 保持) <sup>⑷</sup>	0	0	8MHz	1. 66	1. 39	
		0	0	1MHz	1. 32	1. 29	
		1	0	1MHz	1. 14	1. 11	

- 注: 1. 当 FLASH LP REG=0 时, FLASH 不进入低功耗模式
  - 2. 以上为实测参数。
  - 3. 当 FHCLK 超过 16MHz 时,设置 LDO\_EC=0,否则默认设置 LDO\_EC=1。

当配置 CC1\_PD 和 CC2\_PD = 1 时,CH32L103K8U6 和 F8U6 芯片的电流消耗将在上述表格的基础上 另加约 5uA; 其他 CH32L103 芯片配置 CC1\_PD 和 CC2\_PD = 1 且 PB6/CC1 和 PB7/CC2 引脚为下拉输入时, 其电流消耗将在上述表格的基础上另加约 5uA。

表 3-7-3 数据处理代码从 SRAM 中运行, FLASH 进入低功耗模式 (1), 设置 LD0TR IM [1:0] = 01

符号	<del>分</del> 米/ <sub>1</sub>		条件		典	型值	单位
	参数	HSILP	PLLON	F <sub>HCLK</sub> (3)	使能所有外设	关闭所有外设	半江
I <sub>DD</sub> (2)	运行模式	0	1	96MHz	6. 32	3. 78	mA

			1	r		Ī
下的供应	0	1	48MHz	3. 41	2. 11	
电流	0	1	8MHz	0. 86	0. 60	
	0	1	1MHz	0. 39	0. 36	
	1	1	8MHz	0. 63	0. 42	
	1	1	1MHz	0. 20	0. 16	
	0	0	8MHz	0. 76	0. 52	
	0	0	1MHz	0. 30	0. 27	
	1	0	1MHz	0. 13	0. 09	
	1	0	500KHz	0. 09	0. 08	
	1	0	125KHz	0. 07	0. 06	
	0	1	96MHz	4. 22	1. 67	
	0	1	48MHz	2. 33	1. 05	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	1	8MHz	0. 68	0. 42	
睡眠模式	0	1	1MHz	0. 37	0. 34	
下的供应	1	1	8MHz	0. 45	0. 24	
电流(此时外设供	1	1	1MHz	0. 17	0. 14	mA
电和时钟	0	0	8MHz	0. 59	0. 34	
保持)(	0	0	1MHz	0. 27	0. 25	
 	1	0	1MHz	0. 10	0. 07	
	1	0	500KHz	0. 08	0. 06	
	1	0	125KHz	0. 06	0. 06	

- 注: 1. 当 FLASH\_LP\_REG=1 且 FLASH\_LP=1 时, FLASH 进入低功耗模式。
  - 2. 以上为实测参数。
  - 3. 当 F<sub>HCLK</sub> 超过 16MHz 时,设置 LDO\_EC=0,否则默认设置 LDO\_EC=1。
- 4. 当配置 CC1\_PD 和 CC2\_PD = 1 时,CH32L103K8U6 和 F8U6 芯片的电流消耗将在上述表格的基础上另加约 5uA;其他 CH32L103 芯片配置 CC1\_PD 和 CC2\_PD = 1 且 PB6/CC1 和 PB7/CC2 引脚为下拉输入时,其电流消耗将在上述表格的基础上另加约 5uA。

表 3-8-1 数据处理代码从 FLASH 中运行, 停止和待机模式下典型的电流消耗

			条件							<b>Ж</b>	
符号	参数	HSI, HSE LSI, LSE	RAMLV	R18KSTY	R2KSTY	LDO_EC	LPDS	PDDS	LD0	典型值	单 位
	STOP 停止模式 1 下的供应电流 <sup>②</sup>	均关闭	无效	无效	无效	0	0	0	10	34. 63	
. I <sub>DD</sub> <sup>(1)</sup>	STOP 停止模式 2 下的供应电流 <sup>②</sup>	均关闭	无效	无效	无效	1	0	0	10	23. 88	
	STOP 停止模式 3 下的供应电流 <sup>②</sup>	均关闭	0	无效	无效	Х	1	0	10	4. 55	uA
	STOP 停止模式 4 下的供应电流 <sup>②</sup>	均关闭	1	无效	无效	Х	1	0	10	4. 08	
	STANDBY 待机模 式下的供应电流	只开启 LSI	0	1	1	无效	无效	1	10	2. 97	uA
	(3)	均关闭	0	1	1	无效	无效	1	10	2. 82	an

		均关闭	1	1	1	无效	无效	1	10	1. 89	
		只开启 LSI	1	0	1	无效	无效	1	10	0. 74	
		均关闭	1	0	1	无效	无效	1	10	0. 59	
		只开启 LSI	无效	0	0	无效	无效	1	10	0. 51	
		均关闭	无效	0	0	无效	无效	1	10	0. 37	
I DD_VBAT	备份区域的供应 电流(移除 V₀₀	只开启 LSE	无效	0	0	无效	无效	1	10	0. 75	
(1)	和 V <sub>DDA</sub> ,只使用 V <sub>BAT</sub> 供电)	均关闭	无效	0	0	无效	无效	1	10	0. 37	uA :

#### 注: 1. 以上为实测参数。

- 2. 当配置 CC1\_PD 和 CC2\_PD = 1 时,CH32L103K8U6 和 F8U6 芯片停止模式下的电流消耗将在上述 表格的基础上另加约 5uA; 其他 CH32L103 芯片配置 CC1\_PD 和 CC2\_PD = 1 且 PB6/CC1 和 PB7/CC2 引脚 为下拉输入时,其停止模式下的电流消耗将在上述表格的基础上另加约 5uA。
- 3. CH32L103K8U6 和 F8U6 内置 5. 1k Ω 下拉电阻,仅对于批号倒数第五位为 1 的产品,由于在待机模式下 5. 1k Ω 下拉电阻的功能强制开启,因此无需注释 2 中的配置,CH32L103K8U6 和 F8U6 芯片待机模式下的电流消耗将在上述表格的基础上另加约 5uA。

表 3-8-2 数据处理代码从 SRAM 中运行, 停止模式下典型的电流消耗

			条件							单	
符号	参数	HSI, HSE LSI, LSE	RAMLV	R18KSTY	R2KSTY	LDO_EC	LPDS	PDDS	LD0	典型值	位
1 <sub>DD</sub> <sup>(1)</sup>	STOP 停止模式 1 下的供应电流 <sup>②</sup>	均关闭	无效	无效	无效	0	0	0	01	30. 94	
	STOP 停止模式 2 下的供应电流 <sup>②</sup>	均关闭	无效	无效	无效	1	0	0	01	20. 22	• uA i

#### 注: 1. 以上为实测参数。

2. 当配置 CC1\_PD 和 CC2\_PD = 1 时, CH32L103K8U6 和 F8U6 芯片停止模式下的电流消耗将在上述 表格的基础上另加约 5uA; 其他 CH32L103 芯片配置 CC1\_PD 和 CC2\_PD = 1 且 PB6/CC1 和 PB7/CC2 引脚 为下拉输入时,其停止模式下的电流消耗将在上述表格的基础上另加约 5uA。

# 3.3.5 外部时钟源特性

表 3-9 来自外部高速时钟

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
F <sub>HSE_ext</sub>	外部时钟频率		3	8	25	MHz
V <sub>HSEH</sub> (1)	OSC_IN 输入引脚高电平电压		0. 8V <sub>DD</sub>		V <sub>DD</sub>	V
V <sub>HSEL</sub> <sup>(1)</sup>	OSC_IN 输入引脚低电平电压		0		$0.2V_{DD}$	V
C <sub>in (HSE)</sub>	OSC_IN 输入电容			5		pF
DuCy <sub>HSE</sub>	占空比(Duty cycle)			50		%
IL	OSC_IN 输入漏电流				±1	uA

注1:不满足此条件可能会引起电平识别错误。

图 3-3 外部提供高频时钟源电路

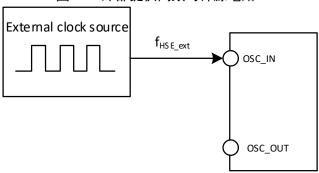


表 3-10 来自外部低速时钟

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$F_{LSE\_ext}$	用户外部时钟频率			32. 768	1000	KHz
$V_{LSEH}$	0SC32_IN 输入引脚高电平电压		0. 8V <sub>DD</sub>		V <sub>DD</sub>	V
$V_{LSEL}$	0SC32_IN 输入引脚低电平电压		0		0. 2V <sub>DD</sub>	V
C <sub>in(LSE)</sub>	0SC32_IN 输入电容			5		рF
DuCy <sub>LSE</sub>	占空比(Duty cycle)			50		%
Iι	0SC32_IN 输入漏电流				±1	uA

图 3-4 外部提供低频时钟源电路

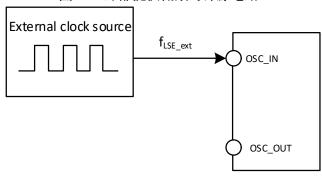


表 3-11 使用一个晶体/陶瓷谐振器产生的高速外部时钟

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
F <sub>osc_in</sub>	谐振器频率		3	8	25	MHz
$R_{\scriptscriptstyle F}$	反馈电阻			250		kΩ
С	建议的负载电容与对应晶体串行阻抗 R <sub>s</sub>	R <sub>S</sub> =60 Ω <sup>(1)</sup>		20		pF
		V <sub>DD</sub> = 3.3V, 20p 负载		1		mA
I <sub>2</sub> <sup>(1)</sup>	HSE 驱动电流	低功耗模式, V <sub>∞</sub> = 3.3V, 20p 负载		0. 55		mA
<b>g</b> <sub>m</sub> <sup>(1)</sup>	振荡器的跨导	启动		21		mA/V
t <sub>SU (HSE)</sub>	启动时间	V远稳定		1. 5 (2)	4. 5	ms

注: 1.25M 晶体 ESR 建议不超过 60 欧,低于 25M 可适当放宽。

<sup>2.</sup> 启动时间指从 HSEON 开启到 HSERDY 被置位的时间差。

#### 电路参考设计及要求:

晶体的负载电容以晶体厂商建议为准,通常情况 CL1=CL2。

#### 图 3-5 外接 8M 晶体典型电路

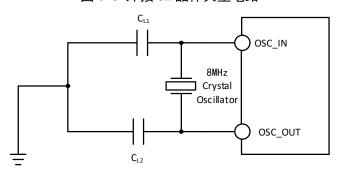


表 3-12 使用一个晶体/陶瓷谐振器产生的低速外部时钟(flse=32.768KHz)

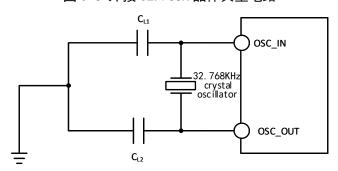
符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$R_{\scriptscriptstyle F}$	反馈电阻			5		MΩ
C <sub>L1</sub> /C <sub>L2</sub>	建议的负载电容与对应晶体串 行阻抗 R <sub>s</sub>	$R_s = 70K \Omega$			15	pF
i <sub>2</sub> <sup>(1)</sup>	LSE 驱动电流	$V_{DD} = 3.3V$		0. 36		uA
g <sub>m</sub> <sup>(1)</sup>	振荡器的跨导	启动		26		uA/V
t <sub>SU(LSE)</sub>	启动时间	V₀ 是稳定的		1000(1)		ms

注 1: 启动时间指从 LSEON 开启到 LSERDY 被置位的时间差。

# 电路参考设计及要求:

晶体的负载电容以晶体厂商建议为准,通常情况 C11 = C12,可选 12pF 左右。

图 3-6 外接 32.768K 晶体典型电路



注: 负载电容  $C_L$  由下式计算:  $C_L = C_{L1} \times C_{L2} / (C_{L1} + C_{L2}) + C_{stray}$ , 其中  $C_{stray}$  是引脚的电容和 PCB 板或 PCB 相关的电容,它的典型值是介于 2pF 至 7pF 之间。

#### 3.3.6 内部时钟源特性

表 3-13 内部高速(HSI)RC 振荡器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
_	频率(校准后)			8		MHz
F <sub>HS1</sub>	「炒火 <del>牛</del> (化)生/口)	低功耗模式		1		MHz
DuCy <sub>HS1</sub>	占空比(Duty cycle)		45	50	55	%
ACCHSI	HSI 振荡器的精度(校准后)	$T_A = 0^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$	-1.8		1.8	%
ACCHSI	NOI 1版初品的相反(牧/田/口)	$T_A = -40^{\circ}C \sim 85^{\circ}C$	-3		2. 5	%

t <sub>SU(HSI)</sub>	HSI 振荡器启动稳定时间			8	us
10145###		200		uA	
DD (HS1)	HSI 振荡器功耗	低功耗模式	24		uA

# 表 3-14 内部低速(LSI)RC 振荡器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
F <sub>LS1</sub>	频率		27	37	47	KHz
DuCy <sub>LSI</sub>	占空比(Duty cycle)		45	50	55	%
t <sub>SU(LSI)</sub>	LSI 振荡器启动稳定时间			400		us
I DD (LSI)	LSI 振荡器功耗			150		nA

# 3.3.7 PLL 特性

# 表 3-15 PLL 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
F	PLL 输入时钟		3	8	25	MHz
$F_{PLL_{IN}}$	PLL 输入时钟占空比		40		60	%
F <sub>PLL_OUT</sub>	PLL 倍频输出时钟		18		96 <sup>(1)</sup>	MHz
t <sub>LOCK</sub>	PLL 锁定时间			80	200	us
I <sub>DD (PLL)</sub>	PLL 功耗	输入频率 8M, 输出频率 96M		0. 15		mA

注1: 须选择合适倍频,满足PLL输出频率范围。

# 3.3.8 从低功耗模式唤醒的时间

# 表 3-16 低功耗模式唤醒的时间 (1)

符号	参数	条件	典型值	单位
twusleep	从睡眠模式唤醒	使用 HSI RC 时钟唤醒	0. 2	us
twustop	从停止模式唤醒	使用 HSI RC 时钟唤醒	7	us
twustdby	从待机模式唤醒	使用 HSI RC 时钟唤醒	72	us

# 注:以上为实测参数。

# 3.3.9 存储器特性

# 表 3-17 闪存存储器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
t <sub>prog_page</sub>	页(256 字节)编程时间			2. 0	2. 5	ms
t <sub>erase_page</sub>	页(256 字节)擦除时间			6. 2	7. 5	ms
t <sub>erase_sec</sub>	扇区(1K 字节)擦除时间			6. 2	7. 5	ms

# 表 3-18 闪存存储器寿命和数据保存期限

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
N <sub>END</sub>	擦写次数	$T_A = 25^{\circ}C$	300K			次
		$T_A = 70^{\circ}C$	100K			次
t <sub>ret</sub>	数据保存期限	$T_A = 25^{\circ}C$	20			年
		$T_A = 70^{\circ}C$	10			年

#### 3.3.10 I/0 端口特性

表 3-19 通用 1/0 静态特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V <sub>IH</sub>	标准 I/0 引脚,输入高电平电压		0. 41*(V <sub>DD</sub> -1. 8)+1. 3		V <sub>DD</sub> +0. 3	٧
	FT I/0 引脚,输入高电平电压		0. 42* (V <sub>DD</sub> -1. 8) +1. 2		5. 5	V
	B00T0 引脚,输入高电平电压		0. 85*V₪		V <sub>DD</sub> +0. 3	V
VıL	左发 L/O 引脚 - 烧入低中亚中耳		-0.3		0. 28* (V <sub>DD</sub> -	٧
	标准 I/0 引脚,输入低电平电压		-0. 3		1. 8) +0. 6	V
	FT I/0 引脚,输入低电平电压		-0. 3		0. 32* (V <sub>DD</sub> -	V
					1. 8) +0. 55	
$V_{hys}$	标准 I/0 施密特触发器电压迟滞		150			mV
<b>V</b> hys	FT I/0 施密特触发器电压迟滞		90			mV
,	标准 I/0 引脚输入漏电流				1	u <b>A</b>
lkg	FT I/O 引脚输入漏电流				3	u <b>A</b>
$R_{\text{PU}}$	上拉等效电阻		30	40	50	kΩ
$R_{\text{PD}}$	下拉等效电组		30	40	50	kΩ
Cıo	1/0 引脚电容	·		5		pF

注: 以上均为设计参数保证。

#### 输出驱动电流特性

GP10(通用输入/输出端口)可以吸收或输出多达 $\pm 8mA$  电流,并且吸收或输出 $\pm 20mA$  电流(不严格达到  $V_{ol}/V_{ol}$ )。在用户应用中,所有 10 引脚驱动总电流不能超过 3.2 节给出的绝对最大额定值:

表 3-20 输出电压特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
$V_{oL}$	输出低电平,8个引脚吸收电流	TTL端口,I₀= +8mA		0. 4	V
$V_{OH}$	输出高电平,8个引脚输出电流	2. 7V< V <sub>DD</sub> <3. 6V	V <sub>DD</sub> -0. 4		V
$V_{oL}$	输出低电平,8个引脚吸收电流	CMOS端口, I₁₀= +8mA		0. 4	٧
$V_{OH}$	输出高电平,8个引脚输出电流	2. 7V< V <sub>DD</sub> <3. 6V	V <sub>DD</sub> -0. 4		V
$V_{oL}$	输出低电平,8个引脚吸收电流	I <sub>10</sub> = +20mA		0.8	V
$V_{OH}$	输出高电平,8个引脚输出电流	2. 7V< V <sub>DD</sub> <3. 6V	V <sub>DD</sub> -1. 2		<b>v</b>
V <sub>oL</sub>	输出低电平,8个引脚吸收电流	I <sub>10</sub> = +6mA		0.8	V
$V_{OH}$	输出高电平,8个引脚输出电流	2. 4V< V <sub>DD</sub> <2. 7V	V <sub>DD</sub> -1. 2		V

注:以上条件中如果多个 10 引脚同时驱动,电流总和不能超过 3.2 节给出的绝对最大额定值。另外多个 10 引脚同时驱动时,电源/地线点上的电流很大,会导致压降使内部 10 的电压达不到表中电源电压,从而导致驱动电流小于标称值。

表 3-21 输入输出交流特性

MODEx[1:0] 配置	符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
10 (2MHz)	F <sub>max(10) out</sub>	最大频率	CL=50pF, V <sub>DD</sub> =2. 7-3. 6V		2	MHz
	t <sub>f(I0)out</sub>	输出高至低电平的下降时间	CL=50pF, V <sub>DD</sub> =2. 7-3. 6V		125	ns
	t <sub>r (10) out</sub>	输出低至高电平的上升时间	UL-3Upr, V <sub>DD</sub> -2. 7-3. 0V		125	ns
01	F <sub>max(10)out</sub>	最大频率	CL=50pF, V <sub>DD</sub> =2. 7-3. 6V		10	MHz

(10MHz)	$t_{f(10) out}$	输出高至低电平的下降时间	01 -50-5 V -2 7 2 4V		25	ns
	t <sub>r(10) out</sub>	输出低至高电平的上升时间	CL=50pF, V <sub>DD</sub> =2. 7-3. 6V		25	ns
	_	最大频率	CL=30pF, V <sub>DD</sub> =2. 7-3. 6V		50	MHz
	F <sub>max(10) out</sub>	取入则平	CL=50pF, V <sub>DD</sub> =2. 7-3. 6V		30	MHz
11	_	输出高至低电平的下降时间	CL=30pF, V <sub>DD</sub> =2. 7-3. 6V		5	ns
(50MHz)	t <sub>f(I0)out</sub>		CL=50pF, V <sub>DD</sub> =2. 7-3. 6V		8	ns
	+	输出低至高电平的上升时间	CL=30pF, V <sub>DD</sub> =2. 7-3. 6V		5	ns
	t <sub>r (10) out</sub>	拥山似至同电干的工开时间	CL=50pF, V <sub>DD</sub> =2. 7-3. 6V		8	ns
	t <sub>EXTIPW</sub>	EXTI 控制器检测到外部信号 的脉冲宽度		10		ns

### 3.3.11 NRST 引脚特性

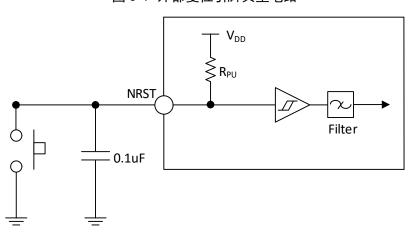
## 表 3-22 外部复位引脚特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V <sub>IL (NRST)</sub>	NRST 输入低电平电压		-0. 3		0. 28*(V <sub>DD</sub> -1. 8)+0. 6	٧
V <sub>IH (NRST)</sub>	NRST 输入高电平电压		0. 41*(V <sub>DD</sub> -1. 8)+1. 3		V <sub>DD</sub> +0. 3	٧
$V_{hys(NRST)}$	NRST 施密特触发器电压 迟滞		150			mV
R <sub>PU</sub> <sup>(1)</sup>	上拉等效电阻		30	40	50	kΩ
V <sub>F (NRST)</sub>	NRST 输入可被滤波脉宽				100	ns
V <sub>NF (NRST)</sub>	NRST 输入无法滤波脉宽		300			ns

注: 1. 上拉电阻是一个真正的电阻串联一个可开关的 PMOS 实现。这个 PMOS/NMOS 开关的电阻很小(约占 10%)。

### 电路参考设计及要求:

图 3-7 外部复位引脚典型电路



注:图中的电容是可选的,可以用于滤除按键抖动。

### 3. 3. 12 USB PD 接口特性

表 3-23-1 PD 接口 I/0 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	単位
$t_{Rise}$	上升时间	幅度 10%到 90%之间的时间, 最小值为无负载条件下的时间。	240	400		ns

t <sub>Fall</sub>	下降时间	幅度 10%到 90%之间的时间, 最小值为无负载条件下的时间。	240	400		ns
V <sub>Swing</sub>	输出电压摆幅 (峰-峰值)		1. 04	1. 12	1. 20	٧
Z <sub>Driver</sub>	输出阻抗		26		90	Ω

### 表 3-23-2 Type-C I/O 端口特性

	符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
					80		uA
I	l <sub>pu</sub>	上拉电流	$PAD < V_{DD}-0.6V$		180		uA
ı					330		uA
	Rd	下拉电阻	Vɒ ≥ 1.6V 或外部上拉 330uA	4. 08	5. 1	6. 12	kΩ

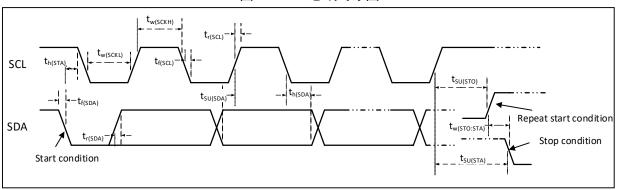
## 3.3.13 TIM 定时器特性

## 表 3-24 TIMx 特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
+	定时器基准时钟		1		t <sub>TIM×CLK</sub>
t <sub>res(TIM)</sub>		$f_{TIMxCLK} = 48MHz$	20.8		ns
F <sub>EXT</sub> CH1 至 CH4 的定时器外部时钟频率		0	f <sub>TIMxCLK</sub> /2	MHz	
	1001 主 004 可足的循外的附件频率	$f_{TIM\times CLK} = 48MHz$	0	24	MHz
R <sub>esTIM</sub>	定时器分辨率			16	位
_	当选择了内部时钟时, 16 位计数		1	65536	t <sub>TIM×CLK</sub>
t <sub>COUNTER</sub>	器时钟周期	f <sub>TIMxCLK</sub> = 48MHz	0. 02	1363	us
t <sub>MAX_COUNT</sub> 最大	   最大可能的计数			65535	t <sub>TIMxCLK</sub>
	取入引起则时效	$f_{TIM\times CLK} = 48MHz$		1363	us

## 3.3.14 I2C 接口特性

## 图 3-8 12C 总线时序图



# 表 3-25 120 接口特性

符号	参数	标准 I2C		快速 120		单位
	<b>多</b> 奴	最小值	最大值	最小值	最大值	十一
t <sub>w(SCKL)</sub>	SCL 时钟低电平时间	4. 7		1. 2		us
t <sub>w (SCKH)</sub>	SCL 时钟高电平时间	4. 0		0. 6		us
t <sub>SU(SDA)</sub>	SDA 数据建立时间	250		100		ns

t <sub>h (SDA)</sub>	SDA 数据保持时间	0		0	900	ns
$t_{r(SDA)}/t_{r(SCL)}$	SDA 和 SCL 上升时间		1000	20		ns
$t_{f(SDA)}/t_{f(SCL)}$	SDA 和 SCL 下降时间		300			ns
t <sub>h (STA)</sub>	开始条件保持时间	4. 0		0. 6		us
t <sub>su(sta)</sub>	重复的开始条件建立时间	4. 7		0. 6		us
t <sub>SU(STO)</sub>	停止条件建立时间	4. 0		0. 6		us
t <sub>w(STO:STA)</sub>	停止条件至开始条件的时间(总线空闲)	4. 7		1. 2		us
Сь	每条总线的容性负载		400		400	pF

## 3.3.15 SPI 接口特性

图 3-9 SPI 主模式时序图

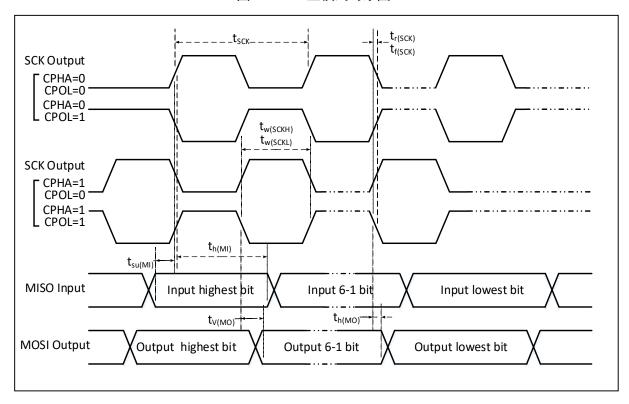


图 3-10-1 SPI 从模式时序图 (CPHA=0, CPOL=0)

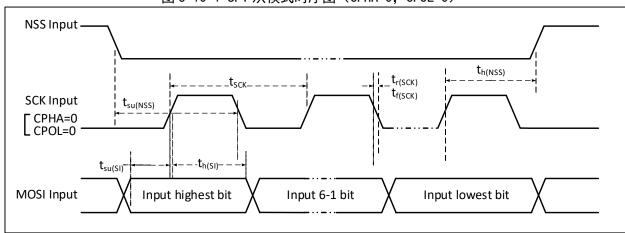


图 3-10-2 SPI 从模式时序图(CPHA=0, CPOL=1)

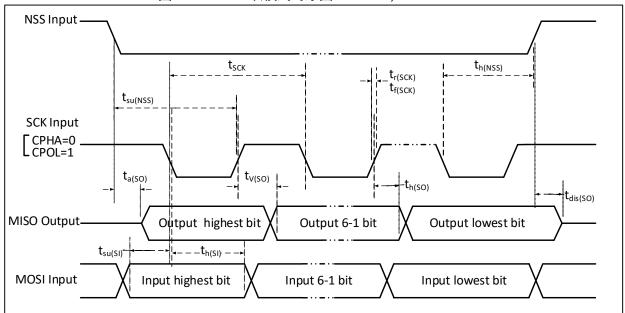


图 3-11-1 SPI 从模式时序图(CPHA=1, CPOL=0)

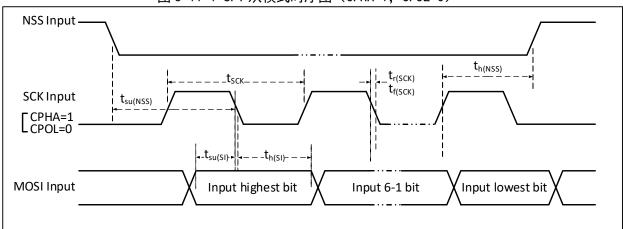
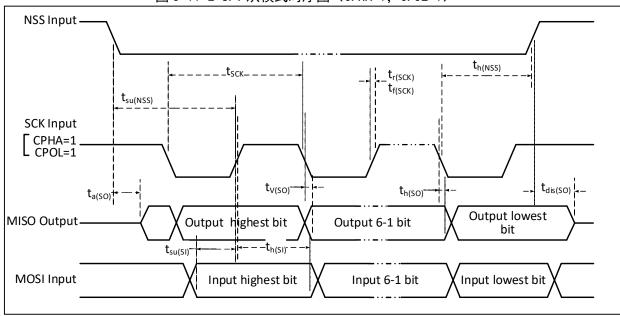


图 3-11-2 SPI 从模式时序图(CPHA=1, CPOL=1)



# 表 3-26 SPI 接口特性

符号	参数	条	·件	最小值	最大值	单位
£ /±	CD I 叶红花文	主模式			32	MHz
f <sub>sck</sub> /t <sub>sck</sub>	SPI 时钟频率	从模式			32	MHz
$t_{r(SCK)}/t_{f(SCK)}$	SPI 时钟上升和下降时间	负载电容: 0	= 30pF		8	ns
t <sub>su (NSS)</sub>	NSS 建立时间	从模式		2t <sub>HCLK</sub>		ns
t <sub>h (NSS)</sub>	NSS 保持时间	从模式		2t <sub>HCLK</sub>		ns
. /+	cov 호마 쪼래((h 꼬마))	主模式, fнсы	= 24MHz,预	70	97	
tw(SCKH)/tw(SCKL)	·····································			70	97	ns
_		主模式	HSRXEN = 0	15		
t <sub>su(MI)</sub>	数据输入建立时间	主模式	HSRXEN = 1	15-0. 5t <sub>sck</sub>		ns
t <sub>su(s1)</sub>		从模式		4		ns
		主模式	HSRXEN = 0	-4		
t <sub>h(MI)</sub>	数据输入保持时间	主模式	HSRXEN = 1	0.5t <sub>sck</sub> -4		ns
t <sub>h(SI)</sub>		从模式		4		ns
t <sub>a (S0)</sub>	数据输出访问时间	从模式, fнсы	= 20MHz	0	1t <sub>HCLK</sub>	ns
t <sub>dis(SO)</sub>	数据输出禁止时间	从模式		0	10	ns
t <sub>V(S0)</sub>	*************************************	从模式(使能边沿之后)			15	ns
t <sub>V (MO)</sub>	数据输出有效时间	主模式(使能边沿之后)			5	ns
t <sub>h(S0)</sub>	*** += +> .  . /= ++ n+ ;=	从模式(使制	<b></b> 能边沿之后)	8		ns
t <sub>h (MO)</sub>	数据输出保持时间 	主模式(使能	能边沿之后)	0		ns

# 3.3.16 USB 接口特性

# 表 3-27 USB I/O 端口特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{\scriptscriptstyle DD}$	USB 工作电压	根据 V∞电压选择 USB 参数	3. 0		3. 6	٧
V <sub>SE</sub>	单端接收器阈值	额定电压	1. 2		1. 9	٧
V <sub>oL</sub>	静态输出低电平				0. 3	٧
V <sub>OH</sub>	静态输出高电平		2. 8			٧
$V_{BC\_REF}$	BC 比较器参考电压			0. 4		٧
$V_{BC\_SRC}$	BC 协议输出电压			0. 6		٧

# 3. 3. 17 12 位 ADC 特性

# 表 3-28 ADC 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V	V <sub>DDA</sub> 供电电压	fs < 200KHz	1. 8		3. 6	٧
<b>V</b> DDA		$f_s = 2.4MHz$	3		3. 6	٧
	I <sub>DDA</sub> 供电电流	$f_s = 2$ . 4MHz Buffer off		1. 2		mA
l ,		$f_s = 2.4MHz$ Buffer on		1. 96		mA
l <sub>DDA</sub>	洪电电测	$f_s = 1MHz$ Buffer off		0. 45		mA
		$f_s = 1MHz$ Buffer on		1. 21		mA
f <sub>ADC</sub>	ADC 时钟频率			14	48	MHz
fs	采样速率		0. 05		2. 4	MHz
f <sub>TRIG</sub>	外部触发频率	$f_{ADC} = 14MHz$			875	KHz

					16	1/f <sub>ADC</sub>
		f <sub>ADC</sub> = 48MHz			2. 2	MHz
		TADO — 40MMZ			22	1/f <sub>ADC</sub>
$V_{\text{AIN}}$	转换电压范围		0		$V_{\text{DDA}}$	V
R <sub>AIN</sub>	外部输入阻抗				50	kΩ
R <sub>ADC</sub>	采样开关电阻			0. 6	1. 5	kΩ
C <sub>ADC</sub>	内部采样和保持电容			4		pF
_	校准时间	f <sub>ADC</sub> = 14MHz			7. 14	us
t <sub>CAL</sub>	↑X/庄中门□J				100	1/f <sub>ADC</sub>
	注入触发转换时延	f <sub>ADC</sub> = 14MHz			0. 143	us
t <sub>lat</sub>		f <sub>ADC</sub> = 48MHz			0. 042	us
					2	1/f <sub>ADC</sub>
	常规触发转换时延	f <sub>ADC</sub> = 14MHz			0. 143	us
t <sub>latr</sub>		f <sub>ADC</sub> = 48MHz			0. 042	us
					2	1/f <sub>ADC</sub>
		$f_{ADC} = 14MHz$	0. 107		17. 1	us
t <sub>s</sub>	采样时间		1. 5		239. 5	1/f <sub>ADC</sub>
L <sub>s</sub>	木件印间	$f_{ADC} = 48MHz$		0. 156		us
				7. 5		1/f <sub>ADC</sub>
t <sub>STAB</sub>	上电时间				1	us
		f <sub>ADC</sub> = 14MHz	1		18	us
_	总的转换时间(包括采样时		14		252	1/f <sub>ADC</sub>
t <sub>conv</sub>	间)	$f_{ADC} = 48MHz$		0. 417		us
				20		1/f <sub>ADC</sub>

注: 以上均为设计参数保证。

公式:最大 RAIN

$$R_{AIN} < \frac{T_S}{f_{ADC} \times C_{ADC} \times \ln 2^{N+2}} - R_{ADC}$$

上述公式用于决定最大的外部阻抗,使得误差可以小于 1/4 LSB。其中 N=12(表示 12 位分辨率)。

表 3-29 f<sub>ADC</sub> = 14MHz 时的最大 R<sub>AIN</sub>

	51151pt	
T <sub>s</sub> (周期)	t <sub>s</sub> (us)	最大 Rain(kΩ)
1. 5	0. 11	1. 2
7. 5	0. 54	12. 3
13. 5	0. 96	23. 3
28. 5	2. 04	50
41. 5	2. 96	75
55. 5	3. 96	无限制
71. 5	5. 11	无限制
239. 5	17. 1	无限制

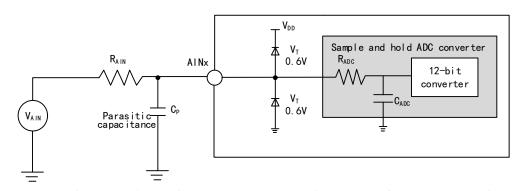
## 表 3-30 ADC 误差

符号   参数 条件   最小值   典型值   最大值   单位	│ 符号 │
-----------------------------------	--------

ET	整体误差	C = 4.4MU	±3	±7	
E0	偏移误差	$f_{ADC} = 14MHz$	±2	±4	
EG	增益误差	$R_{AIN} < 10k \Omega$ , $V_{DD} = 3.3V$ ,	±1	±3	LSB
ED	微分非线性误差	│ vɒ - 3.3v, │ 测量结果经过校准	±2	±5	
EL	积分非线性误差		±2	±5	

注: 以上均为设计参数保证。

图 3-12 ADC 典型连接图



C<sub>p</sub>表示 PCB 与焊盘上的寄生电容(大约 5pF),可能与焊盘和 PCB 布局质量有关。较大的 C<sub>p</sub>数值将降低转换精度,解决办法是降低 f<sub>ADC</sub>值。

0.1uF V<sub>DDA</sub>

图 3-13 模拟电源及退耦电路参考

# 3.3.18 温度传感器特性

表 3-31 温度传感器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
R <sub>TS</sub>	温度传感器测量范围		-40		85	°C
A <sub>TSC</sub>	温度传感器的测量误差			±12		°C
Avg_Slope	平均斜率(负温度系数)		3. 7	4. 2	4. 7	mV/°C
$V_{25}$	在 25°C时的电压		1. 4	1. 45	1. 5	٧
$T_{S\_temp}$	当读取温度时,ADC 采样时间	f <sub>ADC</sub> = 14MHz			20	us

### 3.3.19 OPA 特性

表 3-32-1 OPA 运放特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{\text{DDA}}$	供电电压	建议不低于 2. 4V	1. 8	3. 3	3. 6	٧
V <sub>cm</sub>	共模输入电压		0		$V_{\text{DDA}}$	٧

V	<b>松</b> ) <b>/</b> :田山 [[	松华益		+2	+0	\/
V <sub>10FFSET0</sub>	输入失调电压	校准前		±2	±8	mV
V <sub>IOFFSET</sub>	输入失调电压	校准后		±0.2	±0.8	mV
LOAD	驱动电流	$R_{LOAD} = 4k \Omega$			900	uA
l LOAD_PGA	PGA 模式驱动电流				500	uA
DDOPAMP	消耗电流	无负载,静态模式		220		uA
CMRR <sup>(1)</sup>	共模抑制比	@1kHz		96		dB
PSRR <sup>(1)</sup>	电源抑制比	@1kHz		82		dB
Av <sup>(1)</sup>	开环增益	$C_{LOAD} = 5pF$		115		dB
<b>G</b> <sub>BW</sub> <sup>(1)</sup>	单位增益带宽	$C_{LOAD} = 5pF$		9		MHz
P <sub>M</sub> <sup>(1)</sup>	相位裕度	$C_{LOAD} = 5pF$		75		0
<b>S</b> <sub>R</sub> <sup>(1)</sup>	压摆率	$C_{LOAD} = 5pF$		5		V/us
. (1)	关 闭 到 唤 醒 时	输入 V <sub>DDA</sub> /2, C <sub>LOAD</sub> = 50pF,			0.0	
twakup (1)	间, 0. 1%	$R_{LOAD} = 4k \Omega$			0.8	us
$R_{LOAD}$	阻性负载		4			kΩ
$C_{LOAD}$	容性负载				40	pF
V <sub>OHSAT</sub> (2)	   高饱和输出电压	$R_{LOAD} = 4k \Omega$	$V_{DDA}$ $-250$	V <sub>DDA</sub> -150		mV
<b>V</b> OHSA1	间吃ო制山电压	$R_{LOAD} = 20k \Omega$	$V_{DDA}$ -50	V <sub>DDA</sub> -30		IIIV
V <sub>OLSAT</sub> (2)	<b>化</b> 均和检山由 [[	$R_{LOAD} = 4k \Omega$		3	10	\/
<b>V</b> OLSAT	低饱和输出电压	$R_{LOAD} = 20k \Omega$		3	10	mV
	NSEL=0110 模式同相	Gain = 32, PB10 = GND	-3		3	%
		Gain = 8,	4		4	0/
		$V_{INP} < (V_{DDA}/7)$	-1		1	%
DOA		Gain = 16,	4		4	0/
PGA	中部 <b>同</b> 和 504	$V_{INP} < (V_{DDA}/15)$	-1		1	%
Gain <sup>(1)</sup>	内部同相 PGA	Gain = 32,	4		4	0/
		$V_{INP} < (V_{DDA}/31)$	-1		1	%
		Gain = 64,	_		_	0/
		$V_{INP} < (V_{DDA}/63)$	-1		1	%
Delta R	电阻绝对值变化		-15		15	%
					1	
eN <sup>(1)</sup>	   等效输入噪声	$R_{LOAD} = 4k \Omega@1kHz$		100		nV/

# 注: 1. 设计参数保证;

2. 负载电流会限制饱和输出电压。

表 3-32-2 OPA 特性(低功耗模式)

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{DDA}$	供电电压	建议不低于 2. 4V	1.8	3. 3	3. 6	٧
V <sub>CM</sub>	共模输入电压		0		$V_{\text{DDA}}$	٧
VIOFFSET	输入失调电压			±2	±12	mV
I LOAD	驱动电流	$R_{LOAD} = 10k \Omega$			360	uA
I LOAD_PGA	PGA 模式驱动电流				500	uA
DDOPAMP	消耗电流	无负载,静态模式		40		uA
CMRR <sup>(1)</sup>	共模抑制比	@1kHz		90		dB
PSRR <sup>(1)</sup>	电源抑制比	@1kHz		78		dB

Av <sup>(1)</sup>	开环增益	$C_{LOAD} = 5pF$		115		dB
<b>G</b> <sub>BW</sub> <sup>(1)</sup>	单位增益带宽	C <sub>LOAD</sub> = 5pF		4		MHz
P <sub>M</sub> <sup>(1)</sup>	相位裕度	C <sub>LOAD</sub> = 5pF		76		0
<b>S</b> <sub>R</sub> <sup>(1)</sup>	压摆率	C <sub>LOAD</sub> = 5pF		2. 2		V/us
t <sub>WAKUP</sub> (1)	关闭到唤醒时	输入 V <sub>DDA</sub> /2, C <sub>LOAD</sub> = 30pF,			1, 1	
LWAKUP	间, 0. 1%	$R_{LOAD} = 4k \Omega$			1. 1	us
R <sub>LOAD</sub>	阻性负载		10			kΩ
$C_{LOAD}$	容性负载				30	pF
V <sub>OHSAT</sub> (2)	高饱和输出电压	$R_{LOAD} = 10k \Omega$	V <sub>DDA</sub> -300	V <sub>DDA</sub> -180		mV
V OHSAT	同地州制山电压	$R_{LOAD} = 20k \Omega$	V <sub>DDA</sub> -60	$V_{DDA}$ -35		IIIV
V <sub>OLSAT</sub> (2)	   低饱和输出电压	$R_{LOAD} = 10k \Omega$		4	15	mV
<b>V</b> OLSAT	低饱和制出电压 	$R_{LOAD} = 20k \Omega$		4	15	mv
	NSEL = 0110 模式同相	Gain = 32, PB10 = GND	-3		3	%
		Gain = 32,	-1		1	%
		$V_{INP} < (V_{DDA}/31)$	'		'	/0
PGA		Gain = 8,	-1		1	%
Gain <sup>(1)</sup>	  内部同相 PGA	$V_{INP} < (V_{DDA}/7)$	<b>'</b>		'	/0
darii		Gain = 16,	-1		1	%
		$V_{INP} < (V_{DDA}/15)$	'		'	70
		Gain = 32,	-1		1	%
		$V_{INP} < (V_{DDA}/31)$	1		'	/U
Delta R	电阻绝对值变化		-15		15	%
eN <sup>(1)</sup>	   等效输入噪声	$R_{LOAD} = 10k \Omega@1kHz$		100		nV/
CIN CIN	サメ州ハルオル	$R_{LOAD} = 20k \Omega@1KHz$		80		sqrt(Hz)

# 注: 1. 设计参数保证;

2. 负载电流会限制饱和输出电压。

# 3. 3. 20 CMP 特性

表 3-33-1 CMP 电压比较器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{ extsf{DDA}}$	供电电压		1.8	3. 3	3. 6	٧
V <sub>CM</sub>	共模输入电压		0		$V_{\text{DDA}}$	٧
V <sub>IOFFSET</sub>	输入失调电压			±2.8	±10	mV
DDOPAMP	消耗电流			43		uA
$V_{hys}$	迟滞电压			±15		mV
	比较器延时,					
t <sub>D</sub> (1)	V <sub>INP</sub> 从(V <sub>INN</sub> -100mV)	$0 \leqslant V_{INN} \leqslant V_{DDA}$		16	40	ns
	到(V <sub>INN</sub> +100mV)变化					

注: 1. 设计参数保证。

## 表 3-33-2 CMP 电压比较器特性(低功耗模式)

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{ extsf{DDA}}$	供电电压		1.8	3. 3	3. 6	٧
$V_{\scriptscriptstyle CM}$	共模输入电压		0		$V_{DDA}$	V

VIOFFSET	输入失调电压		±4		mV
DDOPAMP	消耗电流		3. 5		uA
(1)	比较器延时,				
t <sub>D</sub> <sup>(1)</sup>	V <sub>INP</sub> 从(V <sub>INN</sub> -100mV)	$0 \leqslant V_{INN} \leqslant V_{DDA}$	251	400	ns
	到(V <sub>INN</sub> +100mV)变化				

注: 1. 设计参数保证。

# 第4章 封装及订货信息

# 芯片封装

订货型号	封装形式	塑体尺寸	引脚节距	封装说明	出货料盘	
CH32L103C8T6	LQFP48	7*7mm	0.5mm	标准 LQFP48 贴片	托盘	
CH32L103K8U6	QFN32	4*4mm	0. 4mm	四边无引线 32 脚	托盘	
CH32L103G8R6	QSOP28	3. 9*9. 9mm	0. 635mm	1/4 尺寸 28 脚贴片	塑管	
CH32L103F8U6	QFN20	3*3mm	0. 4mm	四边无引线 20 脚	卷带	
CH32L103F8P6	TSS0P20	4. 4*6. 5mm	0. 65mm	薄小型的 20 脚贴片	塑管、卷带	

说明: 1. QFP/QFN 一般默认为托盘。

2. 托盘尺寸: 托盘大小一般为统一尺寸, 322. 6\*135. 9\*7. 62, 不同封装类型限位孔尺寸有区别, 塑管不同封装厂有区别, 具体与厂家确认。

说明:尺寸标注的单位是 mm(毫米),引脚中心间距总是标称值,没有误差,除此之外的尺寸误差不大于±0.2mm或者±10%两者中的较大值。

图 4-1 LQFP48 封装

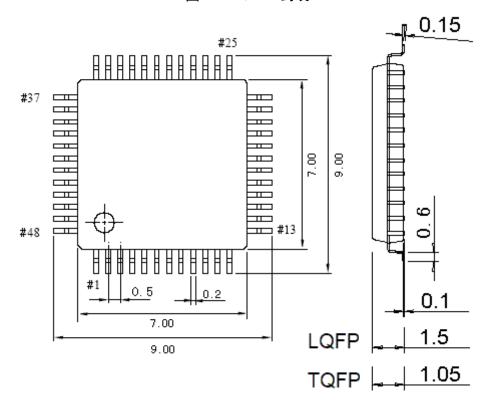


图 4-2 QFN32 封装

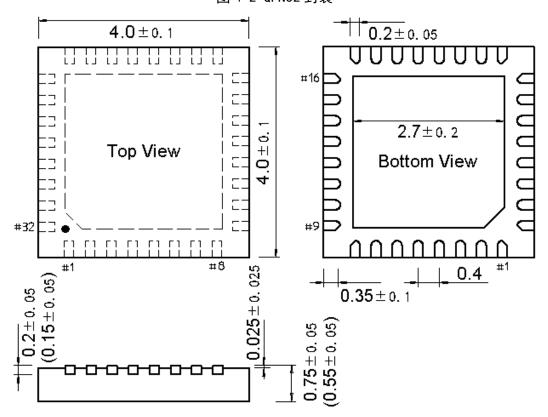
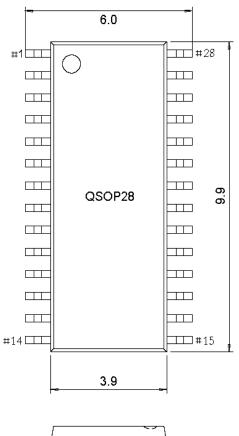
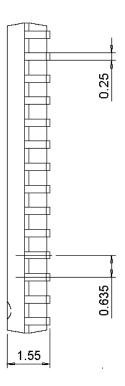


图 4-3 QSOP28 封装





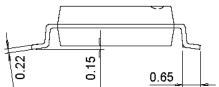
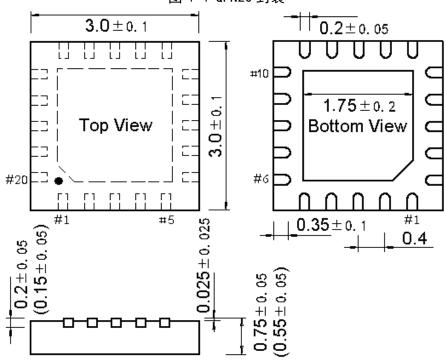
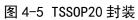
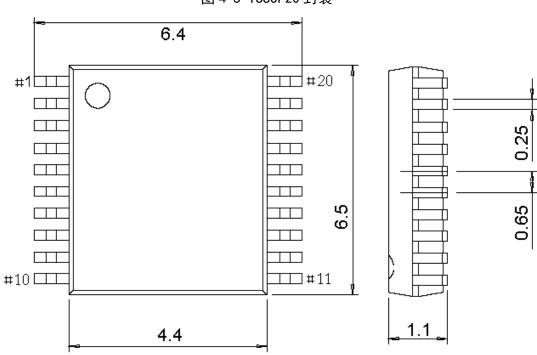
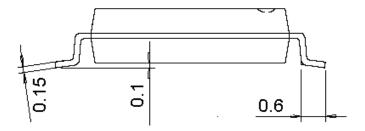


图 4-4 QFN20 封装









# 系列产品命名规则

产品系列

F = 基于 ARM 内核, 通用 MCU

V = 基于青稞 RISC-V 内核, 通用 MCU

L = 基于青稞 RISC-V 内核, 低功耗 MCU

X = 基于青稞 RISC-V 内核, 专用架构或特殊 10

**CH32** 

#### 产品类型

举例:

0 = 青稞 V2/V4 内核, 主频@48M

1 = M3/青稞 V3/V4 内核, 主频@72M

2 = M3/青稞 V4 非浮点内核, 主频@144M

3 = 青稞 V4F 浮点内核, 主频@144M

#### 产品子系列

03 = 通用型

05 = 连接型(USB 高速、SDIO、双 CAN)

07 = 互联型(USB 高速、双 CAN、以太网、SDIO、FSMC)

08 = 无线型(蓝牙 BLE5. X、CAN、USB、以太网)

35 = 连接型(USB、USB PD)

#### 引脚数目

J = 8 脚 A = 16 脚 F = 20 脚

G = 28 脚 K = 32 脚 T = 36 脚

C = 48 脚 R = 64 脚 W = 68 脚

V = 100 脚 Z = 144 脚

### 闪存存储容量

4 = 16K 闪存存储器

6 = 32K 闪存存储器

7 = 48K 闪存存储器

8 = 64K 闪存存储器

B = 128K 闪存存储器

C = 256K 闪存存储器

#### 封装

T = LQFP U = QFN R = QSOP P = TSSOP M = SOP

#### 温度范围

6 = -40°C~85°C (工业级)

7 = -40℃~105℃ (汽车2级)

3 = -40℃~125℃ (汽车1级)

D = -40°C~150°C (汽车0级)